

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لثاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂

بحث مقدم الى قسم البيئة كلية العلوم جامعة القادسية كجزء من متطلبات نيل درجة بكالوريوس في العلوم البيئية

من قبل سعد قيس حسين و على عبد الحسين طه

أشراف م.د سليم حمزة الطويل

1439 هـ

2018 م

بسنم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

صدق الله العلى العظيم

سورة التوبة - الآية (١٠٥)

إقرار المشرف

أقر أن إعداد البحث الموسوم " دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لشاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂" تمت تحت إشرافي في كلية العلوم/ جامعة القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل درجة بكالوريوس علوم في البيئة. أسم المشرف: د. سليم حمزة الطويل

المرتبة العلمية: مدرس

التوقيع:

التاريخ: / /2018.

توصية رئيس قسم البيئة

بناءاً على التوصية المقدمة من قبل د. سليم حمزة الطويل أحيل هذا البحث إلى لجنة المناقشة لبيان الرأى فيه.

> الاسمين د. خديجة عبيس الخالدي المرتبة العلمية: أستاذ مساعد

> > التوقيع: التاريخ: / / 2018.

شکر وتقدیر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى كلية العلوم للتسهيلات المقدمة خلال فترة البحث . كما ونقدم شكرنا الى المشرف الفاضل د. سليم حمزة الطويل لاقتراحه مشروع البحث ولصبره الجميل معنا وتوجيهاته التي كانت لها الفضل في انجاز هذا البحث. واقدم شكري الى اساتذتي الكرام في قسم البيئة لما أبدوه من عون طيلة فترة البحث.

وجزيل الشكر والتقدير الى د. خديجة عبيس الخالدي (رئيسة قسم البيئة) و م. ثائر عبد (مقرر قسم البيئة).

وأيضاً أوجه شكري وتقديري الى د. عبد الكريم السامرائي في جامعة بغداد / كلية العلوم / قسم الكيمياء ، والى ا.م. د شيماء عواد كاظم في جامعة الكوفة / كلية العلوم / قسم الفيزياء والى السيد رافع طعمة احمد في جامعة بابل /كلية العلوم بنات / قسم الفيزياء على جميع الجهود التي بذلوها لإخراج هذا العمل بهذه الصورة. والى زملائي وزميلاتي.

واخيراً اشكر كل من ساعدني ونصحني ولو بكلمة طيبة ... والله الموفق.

سعد و على

الاهداء

الى من عانى سنين طويلة لأجل تلك اللحظات المثمرة والدي الى منبع الحنان الذي لا ينضب والدتي الى من اشد بهم ازري مثال التعاون والعطاء اخوتي واخواتي الى كل من افادني ولو بلفظة اساتذتي الى من طالت بهم اشواق الانتظار اصدقائي الى كل من ودني ولو للحظة احبائي الى كل من ودني العزيزة

المحتويات

رقم الصفحة	العنوان	الفقرة
10-1	مقدمة	الفصل الأول
1	المقدمة	1-1
2	منظومة الليزر	2-1
3	الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمادة TiO ₂	3-1
5	الخصائص العامة لمادة TiO ₂ ذات طور Rutile	4-1
6	الخصائص العامة لمادة TiO ₂ ذات طور Brookite	5-1
7	الدر اسات السابقة	6-1
10	الهدف من البحث	7-1
22-11	الجزء نظري	الفصل الثاني
11	مقدمة	1-2
11	التركيب البلوري لأشباه الموصلات	2-2
11	أشباه الموصلات البلورية	1-2-2
11	أشباه الموصلات البلورية احادية التبلور	2-2-2
11	أشباه الموصلات متعددة التبلور	3-2-2
12	تقنيات الخصائص التركيبية	3-2
12	تقنيات طيفية	1-3-2
12	تقنيات تدرس طوبو غرافية السطح	2-3-2
13	حيود الاشعة السينية	3-3-2
14	معدل الحجم البلوري	4-3-2
15	كثافة الانخلاعات وعدد البلورات	5-3-2
15	تشوه البلورة (المطاوعة المايكروية)	6-3-2
16	الثوابت الشبيكية	7-3-2
16	تقنيات الخصائص البصرية	4-2
17	الامتصاص البصري	1-4-2
17	الامتصاصية	2-4-2
18	معامل الامتصاص وحافة الامتصاص الأساسية	3-4-2
20	الانتقالات الإلكترونية	5-2
20	الانتقال المباشر	1-5-2
22	الانتقال غير المباشر	2-5-2
23	الثوابت البصرية	6-2
23	فجوة الطاقة البصرية	1-6-2
24	معامل الانكسار	2-6-2
24	معامل الخمود	3-6-2
25	ثابت العزل الكهربائي	4-6-2
25	التوصيلية البصرية	5-6-2
26	التلدين	7-2

33-27	الجزء العملي	الفصل الثالث
27	المقدمة	1-3
28	تحضير أقراص المادة	2-3
28	تحضير القواعد الزجاجية	3-3
28	منظومة التبخير	4-3
29	منظومة الليزر	5-3
29	عملية الترسيب	6-3
30	التلدين الحراري	7-3
30	قياس السمك	8-3
31	القياسات التركيبية	9-3
31	قياس حيود الاشعة السينية	1-9-3
31	طبو غرافية السطح	2-9-3
32	القياسات البصرية	10-3
32	حساب معامل الامتصاص	1-10-3
32	حساب فجوة الطاقة	2-10-3
32	الثوابت البصرية	11-3
32	معامل الانكسار	1-11-3
33	معامل الخمود	2-11-3
33	ثابت العزل الكهربائي	3-11-3
48-34	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
34	المقدمة	1-4
34	نتائج القياسات التركيبية	2-4
34	حيود الأشعة السينية	1-2-4
34	تأثير درجة حرارة الأساس	2-2-4
36	قياسات المجهر الالكتروني الماسح	3-2-4
36	قياسات مجهر القوة الذرية	4-2-4
38	الخصائص البصرية	3-4
38	طيف الامتصاصية	1-3-4
39	طيف النفاذية	2-3-4
40	طيف الانعكاسية	3-3-4
40	حساب معامل الامتصاص	4-3-4
41	حساب فجوة الطاقة البصرية	5-3-4
43	حساب معامل الانكسار	6-3-4
44	حساب معامل الخمود	7-3-4
44	حساب ثابت العزل الكهربائي	8-3-4
46	حساب التوصيلية البصرية	9-3-4
47	الاستنتاجات	4-4
47	المشاريع المستقبلية	5-4
48	المصادر	

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
	مقدمة	الفصل الأول
4	الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمسحوق TiO ₂	1-1
7	خصائص ثاني اوكسيد التيتانيوم TiO ₂	2-1
	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع
35	نتائج حيود الأشعة السينية لأغشية TiO ₂ المحضرة بتقنية الليزر النبضي	1-4
37	الخصائص تركيبية والطبو غرافية لأغشية TiO ₂	3-4
65	قياسات فجوة الطاقة البصرية المباشرة وغير المباشرة لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم	4-4

قائمة الجداول

قائمة الأشكال

رقم الصفحة	عنوان الشكل	الرقم
	مقدمة عامة	الفصل الأول
2	منظومة الليزر النبضي لترسيب أغشية TiO ₂	1-1
3	ميكانيكية ترسيب الأغشية بالليزر	2-1
5	طور الــ Rutile لمادة ثنائي اوكسيد التيتانيوم	3-1
6	طور Brookite لمادة ثاني اوكسيد التيتانيوم	4-1
	الجانب النظري	الفصل الثاني
12	تركيب المواد الصلبة تبعاً لترتيب ذراتها a- أحادية التبلور، b- متعددة التبلور	1-2
13	حيود براك	2-2
14	جهاز XRD	3-2
16	التقنيات البصرية	4-2
17	عملية الامتصاص لأشباه الموصلات	5-2
18	ظاهرة الامتصاص البصري	6-2
20	معامل الامتصاص على (hv) وتحديد حافة الامتصاص	7-2
22	الانتقالات الالكترونية a- مباشر مسموح b- مباشر ممنوع c- غير مباشر مسموح d- غير مباشر ممنوع	8-2
	الجزء العملي	الفصل الثالث
27	المخطط العملي لتحضير اغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم TiO ₂ الرقيقة	1-3
29	منظومة الليزر النبضي لترسيب أغشية TiO ₂	2-3
30	فرن كهربائي استخدم في عملية تلدين غشاء TiO ₂	3-3
31	طريقة قياس سمك الأغشية الرقيقة المحضرة	4-3
	النتائج والمناقشة	الفصل الرابع

35	حيود الأشعة السينية لأغشية TiO ₂ النقية المحضرة باستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)	1-4
36	صورة SEM لغشاء TiO ₂ المحضر بتقنية الليزر النبضي (PLD)	2-4
37	صور AFM لأغشية TiO ₂ المحضرة بتقنية الليزر النبضي (PLD)	3-4
38	طيف الامتصاصية لأغشية TiO ₂	4-4
39	TiO_2 طيف النفاذية لأغشية	5-4
40	طيف الانعكاسية لأغشية TiO ₂	6-5
41	معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	7-4
42	$ ext{TiO}_2$ العلاقة بين $(lpha ext{hv})^2$ وطاقة الفوتون (hv) لأغشية $ ext{TiO}_2$	8-4
42	$ ext{TiO}_2$ العلاقة بين $(lpha ext{tv})^{1/2}$ وطاقة الفوتون (hv) لأغشية $(lpha ext{tv})^{1/2}$	9-4
43	معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	10-4
44	معامل الخمود كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	11-4
45	ثابت العزل الحقيقي كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	12-4
46	ثابت العزل الخيالي كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	13-4
46	التوصيلية البصرية كدالة للطول الموجي لأغشية TiO ₂	14-4

الخلاصة

تم تحضير أغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂ بوساطة تقنية الترسيب بالليزر النبضي باستخدام ليزر نيدميوم ياك النبضي ذي الطول الموجي nm (532) ، والمرسبة على قواعد زجاجية بظروف تحضير اشتملت على درجة حرارة الأساس C^o 250 ، ضغط اوكسجين mbar⁵ 10 وكثافة طاقة ليزر² 0.08 J/cm وعدد نبضات ليزر (25 ، 50 ، 75) نبضة. وقد درست الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية TiO₂ المحضرة تحت هذه الظروف .

حددت طبيعة التبلور لأغشية TiO₂ بوساطة حيود الأشعة السينية ، فتبين أنها ذات تركيب متعدد التبلور بالاعتماد على ظروف التحضير ، حيث إن تراكيب أغشية TiO₂ تعتمد بشدة على درجة حرارة الأساس ، فقد لاحظنا عند درجة حرار C^o 250 يتحول تركيب الأغشية من طور بروكيت إلى طور الروتيل المستقر.

كما تمت دراسة طبوغرافية السطح لمواد الترسيب باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) ومجهر القوة الذرية (AFM) وكان معدل الحجم الحبيبي حسب قياسات (SEM) هو nm (33) ما بالنسبة لقياسات (AFM) كان معدل الحجم الحبيبي nm 30.55 nm وخشونة السطح nm وجذر متوسط مربع الخشونة هو nm 14.3 nm.

كما درست الخصائص البصرية من خلال قياس طيف الامتصاصية والنفاذية كدالة للطول الموجي لأغشية ₂TiO وكانت نتائج النفاذية البصرية أعـلى من 80 % عند ظروف تحضير معينة مما يـجعلها محلائمة لتطبيقات الخلايا الشمسية. بلغت قيمة فجوة الطاقة البصرية المباشرة eV (3.5) و غير المباشرة مع (3.4) و غير المباشرة eV (3.4) عند درجة حرارة أساس C⁰ 250 وضغط أوكسجين mbar وكثافة طاقة ليزر (3.4) eV (3.4) عند درجة حرارة أساس C⁰ و منغط أوكسجين mbar و 10⁻⁵ mbar وكثافة طاقة ليزر المباشرة mbar و 10⁻⁵ mbar وكثافة طاقة ليزر و 3.5) و غير المباشرة eV و منغط أوكسجين mbar و 10⁻⁵ mbar و عند درجة حرارة أساس c⁰ و منغط أوكسجين abar و 10⁻⁵ mbar و منفط أوكسجين عمل و معامل و كثافة طاقة ليزر و 10⁻² و منفط أوكسجين المات 10⁻² و معامل و معامل الخمود و 10⁻² و معامل الخمود و معامل الخمود و 10⁻² و 10



1-1 المقدمة

Introduction

ثاني اكسيد التيتانيوم او اكسيد التيتانيوم الرباعي هو اكسيد يتكون طبيعيا للتيتانيوم وله الصيغة الكيميائية . TiO₂ عندما يستخدم كخضاب فانه يسمى التيتانيوم الابيض او الابيض الصابغ وهو مشهور بسبب إستخداماته الكثيرة بدئا من الدهان وواق من الشمس الى استخدامه فى تلوين الطعام .

TiO₂ هو شبه موصل من نوع n-type ويمتلك فجوة طاقة تتراوح بين eV (3.04 و3.04) كما له TiO₂ مقاومة نوعية تقدر $\Omega^{12}\Omega$.cm عند درجة حرارة Ω^{0} (25) كما له شفافية عالية في الطيف المرئي.

تم تطبيق تقنية التبخير بالليزر في تصنيع الأغشية الرقيقة مقارنة بتقنية الترسيب المستمر مثل طريقة الأنماء الطبقي ، ان شدة النبضة الليزرية اضافت مميزات جديدة لمراحل تكوين الغشاء في طريقة الترسيب بالليزر (PLD) وأتبعت هذه الطريقة لأنماء عدة طبقات [1].

ان الميزة الأساسية التي تتمتع بها تقنية التبخير الحراري بالليزر هي أن مادة الهدف تتذرى بوساطة نبضات الليزر وتترسب على القاعدة. والمواد المبخرة سوف تصل الى القاعدة في فترة زمنية متزامنة. وفي الوقت الحالي تستخدم تقنية التبخير بالليزر PLD امد نبضة قصير جدا (ns) للحصول على الاغشية الرقيقة لتصنيع الاجهزة الالكترونية والبصرية ، ولقد اخذت تقنية التبخير بالليزر اهتماما كبيرا ، وهناك عدة عوامل تؤثر في خصائص نمو الغشاء المحضر بهذه الطريقة مثل كثافة طاقة الليزر، ودرجة حرارة القاعدة ، و ضغط الاوكسجين ودرجة الفراغ... الخ .

هناك عدة تطبيقات يمكن الاستفادة منها بهذه الطريقة في انماء الاغشية الرقيقة وذلك في صناعة الكواشف، ومتسعات الاغشية الرقيقة، والاجهزة السمعية والكهر وبصرية [2].

يمتاز ثنائي أوكسيد التيتانيوم (TiO₂) بلونه الأبيض وهو عديم الرائحة، وكثافته (4.23 gm/cm³) ومتاز ثنائي أوكسيد التيتانيوم (TiO₂) بلونه الأبيض وهو عديم الرائحة، وكثافته (A.23 gm/cm³) ودرجة انصهاره C^o (1870) وسعته الحرارية (C^o . 298.13 J/mol. ^oC) [8]. وقد نال (TiO₂) اهتماماً شديداً في السنوات الأخيرة بسبب إمكانياته العظيمة في التطبيقات البصرية وفي الأجهزة الالكترونية الدقيقة كمتسعات أو بوابات الكترونية ، كذلك له الكثير من تطبيقات البصرية وفي الأجهزة الالكترونية الدقيقة كمتسعات أو بوابات الكترونية ، كذلك له الكثير من تطبيقات الطاقة الشمسية ولا سيما المجمعات الصوئية - الحرارية الشمسية حيث تتطلب هذه التطبيقات كفاءة عالية ومدى جيداً من الاستقرارية وتتطلب المحميات الضوئية - الحرارية الشمسية حيث تتطلب هذه التطبيقات كفاءة عالية ومدى جيداً من الاستقرارية وتتطلب متصاصية عالية في مدى الطول الموجي المرئي [4] . كذلك يـدخل (TiO₂) فـي تطبيقات المحميات المحميات الغاية في مدى الطول الموجي المرئي [4] . كذلك يـدخل (Gas Sensors) والهيدروكربونات وكواشف الرطوبة [5] .

1

Laser System

2-1 منظومة الليزر

استخدم في عملية التبخير ليزر نبضي من نوع Nd: YAG بزمن نبضة (10 ns) وبطول موجي (532 (mm) وبطاقة قدر ها (Diamond 288 pattern EPLS) . ولقد استعملت عدسة ذات بعد بؤري (mo 5 cm) موديل (focusing) شعاع الليزر ضمن بنف فرتو غرافية لمكونات منظومة ترسيب الأغشية الرقيقة المستعملة في البحث .



شكل (1-1) يوضح منظومة الليزر النبضي لترسيب أغشية TiO₂.

ويوضح المخطط في الشكل (1-2) تقنية التبخير الحراري بالليزر، حيث توضع مادة الهدف في حجرة تفريغ عالية بزاوية 45⁰ مع الليزر النبضي الساقط ان الذرات وايونات التذرية من الهدف سوف تترسب على القاعدة ، حيث يكون سطح القاعدة دائماً بصورة موازية لسطح الهدف وبينهما مسافة معينة [6] .



الشكل (1-2) يوضح ميكانيكية ترسيب الأغشية بالليزر [6] .

عند تصميم حجرة لتبخير الأغشية الرقيقة بطريقة PLD يؤخذ بنظر الاعتبار النقاط الآتية [6]:

- شعاع الليزر يسقط بصورة مباشرة على سطح الهدف، وتستعمل عدسة ذات بعد بؤري مناسب لتبئير شعاع الليزر ليمر من خلال نافذة بصرية تسمح بمرور شعاع الليزر إلى داخل حجرة الترسيب أو استخدام ناقوس زجاجي يسمح بمرور شعاع الليزر.
- 2. تدور مادة الهدف بمستويين y ، x نسبة لشعاع الليزر، وذلك لضمان بقاء بؤرة شعاع الليزر منتظمة مع كل نبضة .
 - تسخن قواعد الترسيب تسخيناً أولياً قبل عملية الترسيب للحصول على التصاقيه عالية للغشاء .
- 4. في بعض الأحيان قد تجهز حجرة الفراغ لمنظومة الترسيب بالليزر بغازات مختلفة مثل (N₂, O₂ أو غيرهما) عندما يتطلب حدوث تفاعل ما بين الغاز ومادة الغشاء أثناء عملية نمو الغشاء.

Physical and chemical properties of الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمادة 3-1 the substance (TiO₂)

هنالك العديد من الأسباب لاختيار ثنائي اوكسيد التيتانيوم في تكوين الأغشية الرقيقة في عملنا هذا ، حيث إن TiO₂ هو مادة فعالة تدخل في صناعة الخلايا الشمسية والمفارق الهجينة وفي الطلاءات المضادة للانعكاس [7]. بالإضافة إلى ذلك أنه رخيص الثمن ويملك نفاذية جيدة في منطقة الطيف المرئي ويملك معامل انكسار واستقراريه كيميائية عالية ، لذلك يفضل استخدامه في الصناعات التكنولوجية الحديثة [8].

ثنائي اوكسيد التيتانيوم موجود في الطبيعة بطوارين رئيسيين هما و TiO₂. Rutile ذو الطور Rutile يكون أكثر استقراراً من باقي الأطوار وأكثر شيوعا أما طور الـ Brookite فهو نادر الوجود في الطبيعة. إن أغشية TiO₂ هي غير متبلورة عند ترسيبها بدرجة حرارة اقل من C^o 300 حيث يبدأ الـطور Brookite بـالـتشكل عـندها ، أمـا الـطور Rutile فانه يتشكل عند درجات حرارة أعلى [9].

الجدول (1-1) يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لثاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂ [10] .

TiO ₂	الخاصية
مسحوق	الحالة
ابیض صلب	المظهر
4.23 g/cm^{3}	الكثافة
1870 °C	درجة الانصهار
2972 °C	درجة الغليان
126.56	ثابت العزل الكهربائي
7	قيمة PH للكمية (100 g/l) عند C ^o 20
$0.24 \text{ W.cm}^{-1}.^{\circ}\text{C}^{-1}$	التوصيلية الحرارية
2.73 للطور Rutile	معامل الانكسار
387nm	الطول الموجي (٨)
3.2 eV للطور	فحدة للطاقة
Rutile	للجوة الصك
12 GPa	الصلابة
8.16 cal/mol. K	السعة الحرارية المولية

الجدول (1-1) يبين بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمسحوق (TiO₂) [10]

General characteristics of the material الخصائص العامة لمادة (TiO₂) ذات طور (TiO₂) والخصائص العامة لمادة (TiO₂) phase Rutile

يعتبر هذا النوع من أكثر الأطوار استقراراً ، نظراً لثبات الخصائص الكيميائية والميكانيكية له . ثاني اوكسيد التيتانيوم هو مادة شبه موصلة من نوع n-type ، أي إن حاملات الشحنة الأغلبية هي الالكترونات ، ويملك TiO₂ فجوة طاقة واسعة . وحدة الخلية لهذا الطور تتكون من ذرات (Ti) التي تحتل مركزاً أساسياً في التركيب البلوري تحيط بها ست ذرات أوكسجين تتركز في زوايا مسبه المجسم الثماني كما في الشكل (1-3) . التركيب البلوري لطور الموار المركز أولا مركز أولا التي تحتل مركزاً مركزاً واسعة . وحدة الخلية لهذا الطور تتكون من ذرات (Ti) التي تحتل مركزاً ما ما واسعة . وحدة الخلية لهذا الطور تتكون من ذرات (Ti) التي تحتل مركزاً ما واسعة . وحدة الخلية لهذا الطور تتكون من ذرات (Ti) التي تحتل مركزاً وايا أساسياً في التركيب البلوري الطور الما الما واليا أساسياً في التركيب البلوري الما والتوايا الما والما والتوايا التي تتركز أوايا أساسياً في التركيب البلوري الما واليا واليا أساسياً في التركيب البلوري الما والتوايا الما والما والم



شكل (1-3) يوضح طور الـ Rutile لمادة ثنائي اوكسيد التيتانيوم [11].

1-5 الخصائص العامة لمادة TiO₂ ذات طور بروكيت

General characteristics of the material TiO₂ phase Brookite

التركيب البلوري لهذا الطور أكثر تعقيداً، وله حجم خلية اكبر من طور Rutile كما أنه أقل كثافة منه. ويتكون من ثماني وحدات خلية بصيغة TiO₂ وحافة تقاسم مضلع بثمان أسطح على غرار طور Rutile كما هو مبين بالشكل (1-4) . التركيب البلوري للطور Brookite هو معيني قائم c = ، b = 5.447 Å ، a = 9.180 Å ما معيني قائم Morthorhombic والثوابت الشبيكية له 180 Å ما عام 2000 ما معيني التيانيوم . Å 5.145 Å



شكل (1-4) يوضح طور Brookite لمادة ثاني اوكسيد التيتانيوم [11].

طور Brookite	طور Rutile	الخاصية
79.890	79.890	الوزن الجزيئي
معيني قائم	رباعي قائم	التركيب البلوري
	وحدة الخلية	
5.455	4.593	a (Å)
9.181	4.593	b (Å)
5.142	2.959	c (Å)
257.630	62.430	لحجم (Å ³)
4.120	4.250	g/cm ³ الكثافة

جدول (1-2) يبين خصائص ثانى اوكسيد التيتانيوم TiO₂ للطورين [11].

Literature Survey

6-1 الدراسات السابقة

تناولت در اسات عديدة خصائص أغشية (TiO₂) لأهميتها في العديد من التطبيقات التكنلوجية ، حيث شهد العام (1977) تطوراً لتطبيقات أغشية ثنائي اوكسيد التيتانيوم كثنائي شوتكي شبه موصل [12].

- في عام (1989) حضر M. Lottiaux وجماعته [13] طبقات رقيقة من ثاني اوكسيد التيتانيوم بسمك مختلف M. Lottiaux وبدرجات حرارية مختلفة 2°(200,250,350) على أرضيات مسمك مختلف M. (200,250,350) وبدرجات حرارية مختلفة 2°(200,250,350) على أرضيات عشوائية التبلور (20, SiO₂) وبدرجات مرارية محتلف مريقة (Vapour Deposition) ، ثم درسوا مصورفولوجية وتركيب الأغشية ، ووجدوا أنها غير متبلورة عند درجات الحرارة 2° (200) مصورفولوجية وتركيب الأغشية ، ووجدوا أنها غير متبلورة عند درجات المحرارة 2° (200) وليكن عند درجات المحرارة C
 وليكن عند درجات المحرارة C
 ولتكن وجدوا انه كلما زاد سمك الغشاء ازداد تجانسه.
- فــي عـــام (1999) درس الــباحث L. Escobar-Alarcon وجــماعته [14] الخصائص الــتركيبية لأغشية (TiO₂) الـمحضرة بـوساطة الترسيب بالليزر (Nd: YAG) (Nd: YAG) وترعد عام (TiO₂) الـمحضرة بـوساطة الترسيب بالليزر (TiO₂) وضـغــط أوكسجيــن (Hz) وبــدرجات حــرارة أرضيــة مختلفـة 2°(100-500) وضـغــط أوكسجيــن (Rutile) وبــدرجات مــرارة الغيرت نتائج طيف رامان إن الأغشية الناتجة هي من نوع (Rutile) المتبلور عند درجات الحرارة العالية مع بعض التركيب العشوائي لبعض الأغشية عند درجات الحرارة المنخفضة. وأظهرت نتائج مليف رامان إن الأغشية (TiO₂) عندما تزداد درجة حرارة المنخفضة. وأظهرت نتائج مع بعض التركيب العشوائي لبعض الأغشية عند درجات الحرارة المنخفضة. وأظهرت نتائج مع بعض التركيب العشوائي المند الأغشية عند درجات الحرارة المرارة المنخفضة. وأظهرت نتائج مع بعض التركيب العشوائي المند الأغشية ويندا الرامية ويندفض ضغط الأوكسجين .

- في عام (2000) درس الباحث M. P. Moret وجماعته [15] تركيب أغشية (TiO₂) المرسبة على أرضيات من السليكون (PLD) عند درجة حرارة C° (750) بوساطة تقنية (PLD) باستخدام ليزر الاك سايمر (248nm)، ووجدوا من خلال نتائج فحوصات طيف رامان وحيود الاشعة السينية إن الطور السائد هو طور ال Brookite بنسبة %45 يليه طور ال Anatase بنسبة %50 م طور ال م طور ال 100 بنسبة %50 بنسبة %50 م طور ال 100 بنسبة %50 بنسبة %50 م طور ال 100 بنسبة %50 م طور ال 100 بنسبة %50 بنسب
- في عام (2001) حضر الباحثان TiO₂) حضر الباحثان (r.f 1356 MHz)، فوجدا أن تشويب TiO₂ بنسب قليلة من والمشوبة باستخدام تقنية التردد الراديوي (r.f 1356 MHz)، فوجدا أن تشويب NO₂ بنسب قليلة من Nb · Ce
 Nb · Ce سوف يغير تركيب الأغشية من الطور المختلط Anatase/Rutile إلى الطور عشية مع الأغشية فقط ، كذلك وجدا أن الأغشية النقية تملك قيماً عالية من ثابت العزل البصري بالمقارنة مع الأغشية المشوبة.
- في عام (2002) حضر الباحث D. Dzibrou وجماعته [17] أغـشية 2002 على أرضيات من السليكون والكوارتز بوساطة الترسيب بالليزر Nd:YAG (λ=355 nm,10 Hz) وبكثافة طاقة ليزر قدرها 352 ما المحمين والكوارتز بوساطة الترسيب بالليزر عدارة مختلفة C[°] (300-500) بالهواء لمدة ساعة واحدة . وقد حصلوا على أغشية ذات خصائص بصرية جيدة ، وأظهرت نتائج فحوصات XRD واحدة . وأخشية الملدنة عند درجة حرارة C[°] (300 غير متبلورة ولكنها تتبلور عند درجة حرارة C[°] (300 من والكورة ولكنها تتبلور عند ورارة محمد المحمد المح
- فـ ي عام (2003) درس الباحث A. K. Sharma وجماعته [18] تـ ركيب أغشية (2003) المرسبة بوساطة الليزر النبضي باستخدام ليزر Nd:YAG (1064 nm) وليزر الاكسايمر XrF (355 nm) KrF (1064 nm) وليزر الاكسايمر على أرضيات من السيليكون (111) والزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال على أرضيات من السيليكون (2011) في والزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال قياسات A. K. Sharma و 1064 nm) مو الزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال على أرضيات من السيليكون (2011) في والزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال على أرضيات من السيليكون (2011) والزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال على أرضيات من السيليكون (2011) والزجاج عند درجة حرارة الغرفة. حيث وجدوا من خلال قياسات A. K. Sharma و 1064 من الموجي عند العور عندين الغشاء في الهواء، أما الأطوار الثلاثة فتظهر مجتمعة عند الطول الموجي 355 nm (1064 nm) والغشاء .
- في عام (2004) حضر Sin-iti Kitazawa وجماعته [19] أغشية (TiO₂) على أرضيات من (2004) حضر Sin-iti Kitazawa بليزر الاكسايمر ArF بطول موجي (α-Al₂O₃) وأمد نبضة (α-Al₂O₃) وتردد (α-Al₂O) وبطاقة نبضة (100 mJ) عند درجة حرارة أساس C⁰ (500).
 ومن خلال تشخيص تركيب الأغشية تم توضيح التفاعل الحاصل بين جزيئات Ti وغاز الأوكسجين ،

وقد درس سمك الغشاء ومورفولوجية السطح بوساطة SEM, AFM, XRD . وفي نفس السنة حضر Yoshiaki Suda وجماعته [20] أغشية (TiO₂) على أرضيات مختلفة بوساطة ليزر الاكسايمر τ=3.5 ns, λ=532 nm) KrF) وكثافة طاقة الليزر (J/cm²) ، فأظهرت جميع الأغشية طور الـ Anatase عند المستوي (101).

- في عام (2005) حضر Tamiko Ohshima وجماعته [21] أغشية (2005) باستخدام تقنية PLD ببستخدام تقنية (TiO) بنسيع أهداف (90.90) بوساطة ليزر الاكسايمر XeCl وبطول موجي (308 nm) لتشعيع أهداف TiN بنقاوة ((99.99%) وأهداف 2005 بنقاوة ((99.99%) في خليط من غازي (20/2)) ، حيث لاحظوا تغير لون الأغشية وأهداف TiO بنقاوة ((99.99%) في خليط من غازي (20/2)) ، حيث لاحظوا تغير لون الأغشية من اللون الابيض للـ TiO إلى اللون البني الغامق بزيادة نسبة تركيز غاز النتروجين ، وأن التركيب البلوري للأغشية يعتمد بشكل كبير على نسبة تركيز النتروجين في خليط الغاز وكذلك على نوع مادة البلوري الهدف.
- في عام (2007) درس الباحث Dongsum Yoo وجماعته [22] تأثير التلدين الحراري على الخصائص التركيبية والبصرية لأغ شية (TiO₂) المحضرة باستخدام الــترسيب بطريقة الترذيذ المغنتروني (RF magnetron sputtering) عند درجة حرارة الغرفة على أرضيات من السليكون (100)، حيث لدنت الأغشية عند درجتي حرارة O° (700,800) على التوالي . وقد أظهرت قياسات العباري النا يتركيب الأغشية هو من نوع Anatase و العماري على المهرت قياسات العبرية إن تركيب الأغشية هو من نوع عمي ما و 3.0 (100) على التوالي . وقد السليكون (100) مان تركيب الأغشية هو من نوع Anatase و المعربة المهرت قياسات الـبصرية إن تركيب الأغشية هو من نوع Anatase و 3.0 (100) على التوالي . وقد المهرت قياسات الـبصرية إن قيمة فجوة الطاقة تزداد من 9 3.9 إلى 8 3.4 واظهرت المورث المهرت قياسات الـبصرية إن قيمة فحوة الطاقة تزداد من 9 3.9 (200) بلى 3.4 في درس الباحثان المهربة حرارة التلدين من 0° (700) إلى 2° (800) . وفي نفس الـسنة درس الباحثان (TiO₂) المحضرة بتقنية Anatase من دوجة حرارة أرضية من المعنية درس الباحثان الـقياسات الـبصرية إن قيمة فحوة الطاقة تزداد من 9 3.9 إلى 8 4.5 عند زيادة درجة حرارة التلدين من 10° (700) إلى 2° (800) . وفي نفس الـسنة درس الباحثان الـقياسات الـبصرية إن قيمة فحوة الطاقة تزداد من 100) . وفي نفس الـسنة درس الباحثان درجة حرارة أرضية 2° (800) . وفي نفس الـسنة درس الباحثان (201) المحضرة بتقنية Anatasi and H. Amardjia-Adnani درجة حرارة أرضية 2° (200) باستخدام 3.0 (2.0) وأظهرت النتائج إن الأغشية غير متبلورة، ووجدا أن فجوة الطاقة تتغير من (2.0 (2.0) باستخدام 3.0 (2.0) وأظهرت النتائج إن الأغشية غير متبلورة، ووجدا أن فجوة الطاقة تتغير من (2.0) باستخدام 3.0 (2.0) (2.0) باستخدام 3.0) ما م و ما ما ما و 3.0 (2.0) باستخدام 3.0) ما ما ما و 3.0 (2.0) ما ما ما ما و 3.0) ما ما ما و 3.0 (2.0) ما ما ما ما و 3.0) ما ما ما ما و 3.0) ما ما ما و 3.0) ما ما ما ما و 3.0) ما ما ما ما ما ما ما ما
- فـي عام (2009) تـناول الباحثان S. Sankar and K. G. Gopchandran [24] تـأثير الـ تلدين الحراري في الخواص التركيبية والكهربائية والبصرية لأغشية TiO₂ ذات التركيب النانوي المحضرة بتقنية التبخير بليزر TiO₂ مي الخواص التركيبية والكهربائية والبصرية لأغشية من TiO₂ ذات التركيب النانوي المحضرة بتقنية التبخير بليزر Nd:YAG (π=8ns, 10Hz, λ=532 nm) المحضرة من الطور عامه (πJ/cm²) وكثافة طاقة من MJ/cm² المور عمد وائية التبلين وأن نفاذية الأغشية تقل بزيادة درجة حرارة التلدين وان معامل الانكسار يقـل أيـضا وتتخفض قيمة فجوة الطاقة من 3.07eV إلى 3.07eV.

• في عام (2010) درس الباحث Gaurav Shukla وجماعته [25] تأثير ضغط الأوكسجين والتلدين الحراري في الخواص البصرية والتركيبية لأغشية (TiO₂) المحضرة بوساطة PLD على أرضيات زجاجية ، حيث أظهرت قياسات XRD , FTIR , SEM أنه عند زيادة درجة حرارة التلدين يزداد تجانس الأغشية ويظهر الطور المتبلور المتبلور عشوائي التبلور . Rutile يبدأ بالاضمحلال تدريجياً ويتحول الغشاء إلى عشوائي التبلور .

Aims of the Work

1-7 الهدف من البحث

ان الدر اسة الحالية تهدف إلى ما يأتي :

I- تحضير أغشية رقيقة من مادة TiO₂ باستخدام تقنية الترسيب بالليزر النبضي Nd: YAG في فراغ يصل إلى mbar (⁵) ، تحت ظروف مختلفة شملت درجة حرارة الأساس وضغط الأوكسجين وكثافة طاقة الليزر.

2- استخدام تقنية حيود الأشعة السينية (XRD) والمجهر الالكتروني الماسح (SEM) ومجهر القوى الذرية (AFM) لمعرفة التركيب البلوري للغشاء المرسب وحجم الحبيبات البلورية وتشخيص طبيعة سطح الغشاء .

3- دراسة الخصائص البصرية لأغشية TiO₂ المحضرة باستخدام تقنية الترسيب بالليزر النبضي ومن خلالها تم حساب معامل الامتصاص وفجوة الطاقة البصرية ، وكذلك حساب الثوابت البصرية لأغشية TiO₂ في المنطقة المرئية وتحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي مثل معامل الانكسار ومعامل الخمود وثابت العزل الكهربائي بجزئية الحقيقي والخيالي.



Introduction

يشمل هذا الفصل الجانب النظري لموضوع البحث ، إذ ان المفاهيم والنظريات الواردة فيه سواء أكانت علاقات رياضية أم إيضاحات علمية أم مخططات بيانية تسهم بصورة أو بأخرى في توضيح الجانب العملي من البحث.

2-2 التركيب البلوري لأشباه الموصلات **Crystal Structure of Semiconductors**

يمكن تصنيف المواد شبه الموصلة تبعاً لتركيبها البلوري أو طبيعة ترتيب ذراتها الى صنفين رئيسين هما:

Crystalline Semiconductors

يكون ترتيب الذرات في أشباه الموصلات البلورية بنحو هندسي دوري يتكرر دورياً في الاتجاهات الثلاثة ، تقسم المواد شبه الموصلة البلورية الى قسمين هما:

2-2-2 أشباه الموصلات أحادية التبلور **Single Crystalline Semiconductors**

تمتاز هذه المواد في الحالة المثالية بأن ذراتها أو جزيئاتها مرتبة بنحو تعيد نفسها دورياً وبصورة متكررة غير نهائية في الأبعاد الثلاثة لتكون هيكلاً هندسياً منتظماً، لذا فهي تمتلك نوعاً من التماثل .(Symmetry)

ويدعى ترتيب الذرات هذا في البلورة بترتيب المدى الطويل ((Long Rang Order (LRO)) .[27,26]

كما في الشكل a (1-2) إذ ان ذرات المادة مرتبة في جميع الاتجاهات بأسلوب منتظم ودوري . ويشار الى الترتيب الدوري للذرات في البلورة بالشبيكة (Lattice) التي تتكون من وحدات مكررة على امتداد البلورة، وتسمى كل وحدة من هذه الوحدات بوحدة الخلية (Unit Cell)[28].

3-2-2 أشباه الموصلات متعددة التبلور **Polycrystalline Semiconductors**

هي عبارة عن مجموعة من البلورات التي تحتوي على عدد كبير نسبياً من الذرات تُدعى بالحبيبات (Grains) التي تمتلك كل منها على حدة ترتيب المدى الطويل، لكن الحبيبات ككل تمتلك ترتيب المدى القصير ((Short Range Order (SRO)) ، لان الحبيبات تتجه بنحو شبه عشوائي نسبة إلى بعضها

1-2 مقدمـــــة

1-2-2 اشباه الموصلات البلورية

ال/بعض مما يجعل خصائص اشباه الموصلات متعددة التبلور متكافئة الاتجاهات (Isotropic) خلافاً لأحادية التبلور التي غالباً ما تكون خصائصها غير متكافئة الاتجاهات (Anisotropic)، وتدعى سطوح التقاء الحبيبات البلورية بعضها مع بعض والتي عندها ينقطع الترتيب الدوري لكل حبيبة بحدود الحبيبات (Grains Boundaries)، كما موضح بالشكل b (2-1) وتكون اشباه الموصلات متعددة التبلور اقل استقرار ثرمودايناميكياً من احادية التبلور؛ لإن الطاقة الداخلية الحرة الدنيا تتحدد بطاقة حدود الحبيبات [29].



الشكل (2-1) تركيب المواد الصلبة تبعاً لترتيب ذراتها a- أحادية التبلور، b- متعددة التبلور [30].

3-2 تقنيات الخصائص التركيبية The Structural Properties Techniques

تختلف المعلومات التي يحصل عليها الباحث عند در اسة تركيب الاغشية الرقيقة وذلك بحسب التقنية المعتمدة في ذلك الفحص التي يمكن ان تدعم إحداهما الاخرى . ويمكن تقسيمها الى ثلاث تقنيات رئيسة .

1-3-2 تقنيات طيفية : بمعنى انها تزودنا بمخطط طيفي لحيود الاشعة عند مرورها بالأنموذج تحت الفحص ومن هذه التقنيات تقنية حيود الأشعة السينية (XRF) ، وفلورة الاشعة السينية (XRF).

SEM تقنيات تدرس طوبوغرافية السطح : ومنها تقنية المجهر الالكتروني الماسح AFM (Atomic Force الذرية AFM (Atomic Force) ، ومجهر القوة الذرية AFM مريقة قياسية لقياس خشونة سطح الرقاقة [31] .

3 - تقنيات تدرس التوزيع الذري للتركيب الشبيكي للغشاء : كما في تقنية حيود الالكترونات ذات الطاقات العالية (High Energy Electron Diffraction) والمجهر الالكتروني النافذ عالي التحليل (High Resolution Transmission Electron Diffraction) الذي يزود الباحث بصورة ذرية للأنموذج المرسب ، أذ يمتاز الأنموذج المصور بدرجة وضوح عالية ولا سيما في تحديد الابعاد الذرية للشبيكة .

X-Ray Diffraction

تُستعمل عادة تقنية حيود الأشعة السينية لدراسة التركيب البلوري للأغشية المرسبة ، أذ ان موقع القمم تزودنا بمعلومات عن التركيب الشبيكي واتجاه النمو المفضل ، اما عرض القمم فتبين الحجم البلوري للبلورات المتشكلة في الغشاء . ويوضح الشكل (2-2) انموذجاً بسيطاً للتركيب البلوري يمثل نمط حيود الاشعة السينية عند سقوطها على سطح البلورة وعن طريقه تمكن (W. Bragg) من استنتاج قانونه [33,32].

- $n\lambda = 2d_{hkl}\sin\theta \qquad (1-2)$
 - إذ إن :

(hk1) المسافة البينية للمستويات (hk1)

λ : الطول الموجي

3-3-2 حيود الاشعة السينية



الشكل (2-2) يوضح حيود براك [33] .

وفي هذه الطريقة يتم تغيير الزاوية (θ) بنحو مستمر في أثناء إجراء عملية تشخيص المادة لمعرفة طبيعة بنائها البلوري ، فعند دوران العينة بزاوية (θ) يكون الكاشف قد دار بزاوية (20)، وعليه فإن الزاوية المسجلة على شريط الورق تمثل ضعف الزاوية في قانون براك بشرط أن تكون الأشعة السينية احادية الطول الموجي ، وبذلك يمكن حساب قيمة (d_{hk1}) من المعادلة (2-1) اذا علمت (λ) و(θ) [33]، كما موضح بالشكل (2-3).



و غالبا ما يستعمل الباحثون هذه التقنية عند در اسة الخصائص التركيبية للأغشية المرسبة [34]. ويمكن الاستفادة من طيف حيود الاشعة السينية للحصول على الآتي :

Average Crystallite Size

(Ds) معدل الحجم البلوري (-4-3-2

يتم حساب معدل الحجم البلوري بالاعتماد على معادلة ديباي شرر (Scherer's Formula) [36,35].

$$D_S = \frac{k\lambda}{\beta_{\rm FWHM} \cos\theta} \tag{2-2}$$

FWHM) (Full Width at Half Maximum): عرض المنحني عند منتصف القمة (FWHM) (Full Width at Half Maximum) (Full Content of the second secon

Dislocation Density and Number of Crystals كثافة الانخلاعات وعدد البلورات 5-3-2

تعرف كثافة الانخلاعات بعدد خطوط الانخلاع التي تقطع وحدة المساحة في البلورة [37]، ويتم إيجادها عن طريق العلاقة الآتية [38]:

$$\delta = rac{1}{(D_S)^2}$$
 (3 - 2)
أما عدد البلورات (N_O) لوحدة المساحة فيتم إيجادها على وفق العلاقة الأتية [39]:

$$N_o = \frac{t}{(D_S)^3}$$
(4 - 2)

إذ إن:

t : سمك الغشاء.

Crystal Distortion (Microstrain)

6-3-2 تشوه البلورة (المطاوعة المايكروية)

التشوهات في البلورة تؤدي الى تغيير في المسافة البينية (d_{hkl}) ، او بمعنى اخر ، ان تغير المسافة بين السطوح الذرية تعني وجود تشوه في البلورة مما يعني ان (d_{hkl}) لا تكون متساوية في كل نقطة من نقاط البلورة فيؤدي ذلك الى ان يعكس كل جزء من اجزاء البلورة اشعة سينية بزاوية تختلف عن الجزء الاخر وبالتالي فان الانعكاس الناتج عن اجزاء مختلفة في البلورة سيكون بزوايا مختلفة [40] .

تحدث المطاوعة المايكروية خلال نمو الغشاء اذ تنشا من توسع او انضغاط (Compression) الشبيكة، لجعل الانحراف (Deviation) في المحور (c) في الشبيكة ثابتا ومساويا لقيمة التركيب السداسي القياسي (ASTM) . لذلك فان توسع الانفعال (Strain Broadening) ينتج عن تغير ازاحة الذرات بالنسبة الى موقع الشبيكة الاصلي (Reference Lattice Position) ويمكن حساب المطاوعة الميكروية (S) من المعادلة [2-5].

$$S = \frac{\beta \cos(\theta)}{4} \tag{5-2}$$

Lattice Constants

7-3-2 الثوابت الشبيكية

4-2 تقنيات الخصائص البصرية

المعادلة في ادناه يمكن من خلالها حساب ثوابت الشبيكة لمركب TiO₂ ذات التركيب الرباعي القائم لطور (Rutile).

 $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$ (6-2)

اما المعادلة الاخرى يمكن من خلالها حساب ثوابت الشبيكة لمركب TiO₂ ذات التركيب المعيني القائم لطور (Brookite).

$$\frac{1}{d_{bkl}^2} = \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(7-2)

The Optical Properties Techniques

يمكن عن طريق دراسة الخصائص البصرية للأغشية الرقيقة التعرف على تركيب حزم الطاقة للأغشية الرقيقة، وكذلك معرفة قيمة فجوة الطاقة وفيما إذا كانت مباشرة أم غير مباشرة . لذلك تتنوع التقنيات المستعملة لدراسة الخصائص البصرية تبعاً لاختلاف تعامل المادة مع الموجة الضوئية الساقطة، فالشكل (2-4) يصنف التقنيات البصرية الطيفية لأربع مجاميع رئيسة [41]. وقد استعمل في هذا البحث مطياف الـ(UV-VIS)، وهي تقنية تعتمد على الامتصاصية .



(4-2) يبين التقنيات البصرية المختلفة [41]

Optical Absorption

1-4-2 الامتصاص البصري

يعد احد الوسائل المهمة في دراسة الحالة الصلبة للمادة ، وتعتمد عمليات الامتصاص لشبه الموصل على طاقة الفوتون الساقط وفجوة الطاقة البصرية، فإذا كانت طاقة الفوتونات (hv) مساوية لفجوة الطاقة (E_g)، فيتم امتصاص الفوتونات لتوليد ازواج من (الكترون– فجوة) ، كما مبين في الشكل a (2-10)، اما إذا كانت طاقة الفوتونات (hv) اكبر من فجوة الطاقة (E_g)، فيمكن ان تحدث عملية انتقال في شبه الموصل وينتج تهيج للإلكترون من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل، في حين نتبدد الطاقة الإضافية الموصل وينتج تهيج للإلكترون من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل، في حين نتبدد الطاقة الإضافية الموصل الذاتي (hv) على شكل حرارة ، كما في الشكل b (2-5).وأن كلاً من (a) و(b) يشار اليهما بالانتقال الذاتي (band-to-band).



شكل (2-5) يوضح عملية الامتصاص لأشباه الموصلات[28]

اما اذا كانت طاقة الفوتونات (hv) اقل من فجوة الطاقة (E_g) فلن يتم الامتصاص الا بوجود مستويات طاقة في الفجوة المحظورة ناجمة عن الشوائب الكيمياوية والعيوب الفيزيائية ، كما موضح في الشكل c (5-2). وتدعى هذه العملية بالانتقال غير الذاتي (extrinsic) [28].

2-4-2 الامتصاصية

Absorption

عند سقوط حزمة ضوئية بطاقة $E_g < hv$ على مادة شبه موصلة بسمك (t) ، كما مبين في الشكل (6-2) بشدة ابتدائية I_o ، سوف يمتص جزء من هذه الحزمة ويعتمد معدل الامتصاص على الطول الموجي للضوء الساقط وسمك الأنموذج. ويمكن حساب شدة الضوء النافذ I_T خلال الانموذج من العلاقة الاتية: [41,28]

$$I_{\rm T} = I_{\rm o} \, \mathrm{e}^{-\alpha \mathrm{t}} \tag{8-2}$$

إذ إن a معامل الامتصاص Absorption Coefficient ويقاس بوحدات cm⁻¹. وهذا المعامل يتغير طبقاً للطول الموجي للضوء الساقط وطبيعة المادة.



الشكل (2-6) يوضح ظاهرة الامتصاص البصري

2-4-2 معامل الامتصاص وحافة الامتصاص الأساسية

Absorption Coefficient and Fundamental Absorption Edge

يُعرف معامل الامتصاص (α) بأنه نسبة النقصان في فيض طاقة الإشعاع بالنسبة إلى وحدة المسافة باتجاه انتشار الموجة داخل الوسط ، ويعتمد معامل الامتصاص على طاقة الفوتونات الساقطة (hv) وعلى خصائص شبه الموصل من حيث فجوة الطاقة ونوع الانتقالات الالكترونية التي تحدث بين حزم طاقاته في حساب معامل الامتصاص للأغشية [2] . وتعطى طاقة الفوتون بالمعادلة الآتية [43] :

$$T = (1 - R)^2 e^{-\alpha t}$$
(10 - 2)
!
!
!
!
!

T : النفاذية R : الانعكاسية ويمكن كتابة علاقة النفاذية مع الامتصاصية (A) كالاتي :

$$e^{-2.303A} = (1 - R)^2 e^{-\alpha t}$$
 (12 - 2)
 $e^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2}}$ (R) صغيره جداً يمكن كتابة المعادلة بالنحو الآتي:
 $e^{-2.303A} = e^{-\alpha t}$ (13 - 2)
 $e^{-2.303A} = e^{-\alpha t}$ (13 - 2)
 $\alpha = 2.303 \frac{A}{t}$ (14 - 2)

ويمتاز طيف الامتصاص البصري لجميع أشباه الموصلات، بأنه مشترك في صفة الزيادة السريعة في الامتصاص الذي يحدث عندما تكون طاقة الإشعاع الممتص مساوية تقريباً لعرض فجوة الطاقة المحظورة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل [45].

اذ تُعرف منطقة طيف الأشعة الساقطة والتي تبدأ فيها الالكترونات بالانتقال بحافة الامتصاص (C.B) وتساوي في المقدار الفرق بين موقع أدنى نقطة في حزمة التوصيل (C.B) وأعلى نقطة في حزمة التكافؤ (V.B) [26].

ومن الشكل(2-7) يلاحظ عند الطول الموجي العالي الذي يزيد على قيمة حافة الامتصاص، فإن الامتصاص يكون قليلاً وكذلك الطول الموجي الذي يحدث عنده الامتصاص يدعى بالطول الموجي القاطع (cut off wavelength) إذ إن اقل طاقة يمكن للإلكترون ان يكتسبها للانتقال من حزمة التكافؤ الى حزمة التوصيل. وتكون حافة الامتصاص حادة (sharp) في أشباه الموصلات أحادية التبلور. أما في أشباه الموصلات متعددة التبلور فتكون حافة الامتصاص أقل حدة [45].

الشكل (2-7) يوضح اعتماد معامل الامتصاص على (hv) وتحديد حافة الامتصاص[46].

Electronic Transitions Direct Transition

عندما ينتقل الالكترون من قمة حزمة التكافؤ الى قعر حزمة التوصيل عند النقطة نفسها في فضاء الموجة (K-Space) ضمن الشرط ($\Delta K = 0$) [47] ، سيصاحب هذا الانتقال تفاعل بين الفوتون الساقط وإلكترون حزمة التكافؤ فقط (Photon-Electron Interaction)، إذ يكون كل من الزخم والطاقة محفوظين، كما في الصيغة الآتية [47].

- $E_f E_i = hv$ (15 - 2) $K_f - K_i = q$ (16 - 2)إذ إن :
 - E_f و E_f : الطاقة الابتدائية والنهائية للإلكترون في كل من حزمة التكافؤ والتوصيل على التوالى .

K_i و K_f : متجه الموجة الابتدائي والنهائي للإلكترون في كل من حزمتي التكافؤ والتوصيل وعلى التوالي.

q :متجه الموجة للفوتون الممتص. ويكون متجه الموجة للفوتون الممتص صغيراً جداً مقارنة بقيمة الإلكترون، لذلك يهمل، وبذلك تكون العلاقة في أعلاه على النحو الآتي:



2-5 الانتقالات الالكترونية

2-5-1 الانتقال المباشر

$$E_{f} = E_{i}$$
 (Allowed Direct Transition) أو يدعى هذا النوع من الانتقال بالانتقال المباشر المسموح (Allowed Direct Transition) أو يدعى بالانتقال العمودي ، وعندما يكون انتقال الإلكترون من المناطق المجاورة لمناطق الانتقال المباشر المسموح مع بقاء شرط عدم تغير قيمة متجه الموجة (K) عندها يسمى هذا الانتقال بالانتقال المباشر المسنوع (E-8)، وفي هذا النوع من أشباه الممنوع (Forbidden Direct Transition) ، وكما موضح بالشكل (2-8)، وفي هذا النوع من أشباه الموصلات تعطى معادلة الامتصاص بالعلاقة (2-10) لتاوس [47,32] α hu = B(hu - E_g^{Opt})^r (18-2)

إذ إن :
α : معامل الامتصاص البصري (cm⁻¹)
B : ثابت يساوي
$$\frac{4\pi\sigma_o}{n_ocAE_e}$$
 إذ : σο (التوصيلية المعدنية الصغری)، c (سرعة الضوء)،
 ΔE_g (عرض الذيول للحالات الموضعية)، on (معامل الانكسار)
AE (عرض الذيول الساقط (eV)
r : طاقة الفوتون الساقط (eV)
r : مرتبة الانتقال البصري، ويعتمد على طبيعة الانتقال الالكتروني.
r : مرتبة الانتقال البصري، ويعتمد على طبيعة الانتقال الالكتروني.
got هنا تحدد المعادلة (2-15) نو عية الانتقال في أشباه الموصلات ذات الفجوة المباشرة ، فعندما تكون
ومن هنا تحدد المعادلة (2-15) نو عية الانتقال في أشباه الموصلات ذات الفجوة المباشرة ، فعندما تكون
قيمة (r) مساوية الى (1/2) يكون الانتقال انتقالأ مباشراً مسموحاً، و عندما تكون (3/2) يكون الانتقال
مباشراً ممنوعاً [47].



الشكل (2-8) الانتقالات الالكترونية a- مباشر مسموح b- مباشر ممنوع c- غير مباشر مسموح b- الشكل (2-8) الانتقالات ال

Indirect Transition

2-5-2 الانتقال غير المباشر

يحصل الانتقال غير المباشر للإلكترونات عند عدم تطابق طاقتي قمة حزمة التكافؤ وقعر حزمة التوصيل في فضاء متجه الموجة (K) ، إذ يكون الانتقال بين نقطة في حزمة التكافؤ وأيَّة نقطة في حزمة التوصيل بصورة غير عمودية، وبذلك ستكون قيمة متجه الموجة (ΔK≠0) [32] .

ويصاحب هذا الانتقال تغير في زخم البلورة بسبب تغير زخم الإلكترون المنتقل ، ويعوض هذا التغير في زخم البلورة من الشبيكة، اما عن طريق امتصاص فونون (Phonon) زخمه [$\hbar(K_c - K_v)$] أو عن طريق انبعاث فونون زخمه [$\hbar(K_c - K_v)$]

أي إنه: $K_i + q = K_f \mp K_n$ (19 - 2)إذ إن: · , A 王 : متجه موجة الفونون المنبعث أو الممتص. - 天 · , متجه موجة الفونون المنبعث أو وبإهمال متجه موجة الفوتون لصغره تكون المعادلة (2-16) على النحو الآتي: $K_i = K_f \mp K_n$ (20 - 2)وتدعى أشباه الموصلات التي تمتلك هذه الانتقالات بأشباه الموصلات ذات الفجوة غير المباشرة (Indirect – Band Gap) وفيها تُعطى معادلة الامتصاص بالعلاقة الآتية [47]. $\alpha h \upsilon = \beta_1 (E_a \mp E_a)^r$ (21 - 2)إذ تمثل: (+E_n) : عملية امتصاص فونون . (-E_p) : عملية انبعاث فونون . وهذه الانتقالات على نوعين أيضاً، فعندما ينتقل الإلكترون بين أعلى نقطة في حزمة التكافؤ وأوطأ نقطة في حزمة التوصيل يكون الانتقال من النوع غير المباشر المسموح (Indirect Allow Transition) الذي عنده تكون قيمة (r) في المعادلة (2-18) مساوية الى (2) . وعندما يكون الانتقال من المناطق المجاورة لأعلى نقطة في حزمة التكافؤ الى أوطأ نقطة في حزمة التوصيل يسمى حينها بالانتقال غير المباشر الممنوع (Indirect Forbidden Transition)، وقيمة (r) عنده مساوية الى (3) في المعادلة أعلاه، كما موضح في الشكل (2-8) وتكون عملية الانبعاث أو الامتصاص في هذه الانتقالات معتمدة على درجة الحرارة بخلاف ما هو عليه في الانتقالات المباشرة [47].

Optical Constants

6-2 الثوابت البصرية 6-2 فجوة الطاقة البصرية

Optical Energy Gap

تعد فجوة الطاقة من الثوابت البصرية المهمة، وتعد دالة لدرجة الحرارة، إذ تتغير قيمتها تغيراً طفيفاً مع تغير درجة الحرارة (T) ، إذ تزداد قيمة فجوة الطاقة في بعض اشباه الموصلات ، في حين تقل في بعضها الاخر. كما ان فجوة الطاقة لشبه الموصل النقي لا تكون خالية تماماً، أذ توجد فيها مستويات موضعية ناتجة من العيوب التركيبية [48].

ويمكن حساب فجوة الطاقة من المعادلة التجريبية التي وضعها تاوس بالصيغة الأتية [50,49] :

2-6-2 معامل الانكسار

 $(\alpha h \upsilon)^2 = B^2 (h \upsilon - E_g^{Opt})$ (22 - 2)إذ يتم رسم العلاقة البيانية بين ²(αhυ) و(hυ) بواسطة مد خط مستقيم يكون امتداده قاطعاً لمحور طاقة الفوتون (hv) . إذ يتم تحديد قيمة فجوة الطاقة من نقطة التقاطع التي يكون عندها $(\alpha h \upsilon)^2 = 0$ حيث اعتمد هذه الطريقة اغلب الباحثين في تعيين فجوة الطاقة امثال الباحث (Gordillo) [51]. والباحث (Rusu) [52] ، والباحث (Marfai) وجماعته [53] ، كذلك الباحث (Shixing) [54] .

Refractive Index

يعرف بأنه النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الي سرعته في الوسط ويعطى بالعلاقة الاتية : [48,41] $N = n_o - iK_o$ (23 - 2)N : معامل الانكسار المعقد n_o : معامل الانكسار الحقيقي Ko : معامل الخمود ويرتبط معامل الانكسار مع لعلاقة الآتية [47] :

$$R = \frac{(n_o - 1)^2 + K_o^2}{(n_o + 1)^2 + K_o^2}$$
(24 - 2)

ومن هذه المعادلة يمكن حساب معامل الانكسار على وفق الصيغة الأتية:

$$n_{o} = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^{2} - (K_{o}^{2}+1) \right]^{1/2}$$
(25-2)

$$R = 1 - T - A$$
 (26 - 2)

2-6-2 معامل الخمود

يمثل معامل الخمود كمية الطاقة الممتصة في الغشاء الرقيق، أو بتعبير أدق كمية ما تمتصه إلكترونات المادة من طاقة الفوتونات الساقطة، أي إنه يمثل الخمود أو التوهين الحاصل للموجة الكهر ومغناطيسية داخل المادة. ويعطى معامل الخمود بالعلاقة الآتية [47,41] :

$$K_{o} = \frac{\alpha\lambda}{4\pi}$$
(27 - 2)

24

Dielectric Constant

ويلاحظ ان معامل الخمود يعتمد بصورة أساسية على الطول الموجي الساقط ومعامل الامتصاص (α) الذي يعتمد على نوعية المادة.

4-6-2 ثابت العزل الكهربائي

يحدث التفاعل بين الضوء وشحنات الوسط بسبب عملية امتصاص الطاقة في المادة، وينتج من هذا التفاعل استقطاب لشحنات ذلك الوسط ويوصف هذا الاستقطاب عادة بثابت العزل الكهربائي المعقد للوسط (٤) الذي يعرف بالعلاقة الآتية: .[47] (28 - 2) $\varepsilon = \varepsilon_r - i\varepsilon_i$ إذ إن : 3 : ثابت العزل الكهربائي المعقد ε_r : الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي ε; الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي والعلاقة بين ثابت العزل ومعامل الانكسار بصيغتها العقدية: $\epsilon = N^2$ (29 - 2)وبالتعويض عن قيمة (N) في المعادلة (2-25) نحصل على: $(n_0 - iK_0)^2 = \varepsilon_r - i\varepsilon_i$ (30 - 2)وبحل المعادلة (2-27) نجد ان : $\varepsilon_r = n_o^2 - K_o^2$ (31 - 2) $\varepsilon_{i} = 2n_{o}K_{o}$ (32 - 2)2 - 6 - 5 التوصيلية البصرية **Optical Conductivity** ترتبط التوصيلية البصرية بمعامل الانكسار ومعامل الخمود حسب المعادلة التالية [54] . (33 - 2) $\sigma = 2n_o n k_o \,\omega \,\varepsilon_o$ حيث ان التردد الزاوي : ω

نسماحية الفراغ : ε_o

2-7 التلدين

بعد التعويض في المعادلة (2 – 32) يمكن كتابة المعادلة (2 – 33) بالصيغة التالية : $\sigma = \epsilon_i \omega \epsilon_o$

Annealing

اذا تم تعريض الأنموذج أو الغشاء الرقيق الى درجة حرارة معينة لمدة محدودة تدعى هذه العملية التلدين، وتجرى عادة إما بالفراغ وإما بوجود غاز معين أو بالهواء على وفق الحاجة . ان عملية التلدين قد تساعد على التقليل من العيوب التركيبية، أذ تعطي طاقة حركية لذرات المادة، وبهذا ستحاول ان تعيد ترتيبها وتأخذ مكانها ضمن العيوب التركيبية، أذ تعطي طاقة حركية لذرات المادة، وبهذا ستحاول ان تعيد اجراء التلدين في حيز من العيوب التركيب البلوري [55] ، أو تؤدي الى تفاعل مادة الغشاء مع الأوكسجين عند اجراء التلدين في حيز من الهواء. لذا فان عملية التلدين تختلف تأثيراتها في المادة على وفق نوع المادة الجراء التلدين في حيز من الهواء. لذا فان عملية التلدين تختلف تأثيراتها في المادة على وفق نوع المادة في تحضير بعض اكاسيد المواد مثل 2012 كما ان الغاية من هذه العملية هي تقليل العيوب عن طريق إز الله الإحهادات المتولدة في المادة وإعادة الذرات والمادة وإحداث عملية انتشار للشوائب لزيادة الفعالية إز الله الإجهادات المتولدة في المادة وإعادة الذرات والمادة وإحداث عملية انتشار للشوائب لزيادة الفعالية إز الله الإجهادات المتولدة في المادة وإعادة الذرات والمادة وإحداث عملية انتشار الشوائب لزيادة الفعالية إز الله الإجهادات المتولدة في المادة وإعادة الذرات والمادة وإحداث عملية انتشار الشوائب لزيادة الفعالية المعربينية لها. كذلك تُستعمل لتحويل غشاء رقيق مكون من عدة مواد أو مادة واحدة من الحالة العشوائية الى متعدد التبلور أو من متعدد التبلور الى أحادي التبلور، كذلك يتم القضاء على معظم العيوب متل عليوب الى متوب الرص والانخلاعات بواسطة عملية التلدين [56].

وتقسم بنحوٍ عام عمليات التلدين الحراري الى نوعين أحدهما: التلدين الحراري التقليدي باستعمال الفرن ، والآخر التلدين الحراري السريع ولا سيما تلك التي توظف المصابيح المالوجينية [55].



1-3مقدمة

Introduction

يتضمن هذا الفصل وصف منظومة التبخير بالليزر وعملية تحضير الاغشية اذ تضمن ادراج الخطوات العملية التي أجريت في هذا البحث ابتداء من عملية تحضير العينات وإجراء عملية الترسيب باستعمال منظومة التبخير بالليزر ومن ثم اجراء القياسات التركيبية والبصرية وبعدها دراسة تأثير التلدين في القياسات باتباع طريقة التلدين الحراري في الهواء وتحت درجة الحرارة ثابته وكما موضح بالمخطط شكل (1-3).



شكل (1-3) يبين المخطط العملي لتحضير اغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂ الرقيقة

Prepare of Material Tablets

في هذا البحث اجرى تبخير مادة ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) ذي النقاوة العالية 99.97 % على شكل مسحوق ولا يمكن استعماله على حالته الأغراض التبخير للأسباب الآتية :-

- لا يمكن تثبيت المسحوق بز اوية مائلة وتشعيعه بالليز ر
- ان عملية الكبس توفر كمية من المادة اكبر لوحدة الحجم مما يغيد في عملية التبخير.

لذلك تم التبخير على سطوح اقراص (pellets) من مادة (TiO₂) . ان استعمال المسحوق بعد كبسه يعد افضل من الناحية العملية لإمكانية تقليص حجم الفجوات الهوائية التي تتواجد ضمن القرص الواحد . للقرص الواحد تم وزن (5g) وضعت داخل اسطوانة مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر داخلي قدره 30mm تم الكبس بوساطة مكبس بقوة كبس قدر ها 5 طن بحيث كان سمك القرص (3 ملم) حيث يتيح فرصة استعمال كلا السطحين في عمليات التبخير

Preparation of Glass Bases

لدراسة الخصائص البصرية والتركيبية للأغشية المبخرة استعملت شرائح زجاجية مستعمله في المجاهر الطبية (Slides glass) بالأبعاد (mm) تثبت على القاعدة العليا للمنظومة . نظفت الشرائح الزجاجية على مرحلتين، في المرحلة الأولى استعمل كحول الإيثانول لغرض اذابة الدهون التي قد تكون متواجدة على سطح الزجاج، وفي المرحلة الثانية غمرت الشرائح الزجاجية في ماء مقطر مغلى فترة عشر دقائق ،بعد ذلك أجرى تنشيفها وتجفيفها داخل فرن حراري .

Evaporation System

تتكون منظومة التبخير التي اعتمدت في هذا البحث من جزئيين رئيسين هما:-בجرة التبخبر

- 2 منظومة التفريغ اشتملت حجرة التبخير على ناقوس زجاجي (Bell jar) مصنع من زجاج البايركس بسمك
- (5mm) وقطر (220mm) وارتفاع (450mm) يستند على القاعدة العليا المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ (stainless steel) مربعة الشكل بسمك (14 mm).

تم تزويد حجرة التبخير بمحرك كهربائي بسرعة دورانية قدر ها دورتان في الدقيقة . يستفاد منها لتحريك القرص الحامل لمادة الهدف (Targets).

يعتمد سمك الغشاء المبخر على عدة معاملات من اهمها المسافة بين المادة والشريحة الزجاجية اذ تم وضع المادة المراد تبخير ها مسافة (5cm) عن الشريحة الزجاجية.

28

4-3 منظومة التبخير

2-3 تحضير أقراص المادة

3-3 تحضير القواعد الزجاجية

كان التبخير في كل مراحل البحث في اجواء مفرغة. تم الحصول عليها بواسطة منظومة تفريغ. تكونت منظومة التفريغ ميكانيكية باستخدام مضخة ميكانيكية دوارة ،أوطأ ضغط ممكن الحصول عليه من هذه المضخة من وحدة تفريغ ميكانيكية باستخدام مضخة ميكانيكية دوارة ،أوطأ ضغط ممكن الحصول عليه من هذه المضخة المنازع (Pfeiffer typ.AD 71MZ4) و مقياس للفراغ نوع (Prani gauge) متصل بالحجرة للتعرف على مقدار الفراغ داخل الناقوس الزجاجي .

5-3 منظومة الليزر

Laser System

استعمل في عملية التبخير ليزر نبضي من نوع Nd:YAG بزمن نبضة (10ns) وبطول موجي (1.06μm) وبطاقة قدر ها (mJ) ولقد تم استعمال عدسة ذات بعد بؤري (5cm) موضوعة خارج حجرة التبخير وذلك لبؤرة شعاع الليزر ضمن بقعة صغيرة جدا"(focusing) . والشكل (2-3) يمثل صورة فوتو غرافية لمكونات منظومة ترسيب الاغشية الرقيقة المستعملة في البحث.



شكل (2-3) يوضح منظومة الليزر النبضي لترسيب أغشية TiO₂.

6-3 عملية الترسيب

Deposition Process

بعد تحضير العينات المكبوسة لمادة TiO₂، وتثبيت الشرائح الزجاجية جرى تشعيع مادة ثاني اوكسيد التيتانيوم بشعاع ليزر الـ Nd:YAG بطاقة 80 mJ وعدد نبضات مختلفة (75, 50, 25) نبضة حيث تم الحصول على سمك مقداره 150)nm .

3-7 التلدين الحراري

Thermal Annealing

جرت عملية التلدين الحراري لغشاء TiO₂ المحضر بطريقة الترسيب بوساطة الليزر النبضي بدرجات حرارة C° (400) لغشاء TiO₂ وزمن تلدين مقدار ها 30 min اذ تم استعمال فرن كهربائي لأجراء عملية التلدين في الهواء الجوي كما في الشكل (3-3).



400°C شكل (3-3) يوضح فرن حرق استخدم في عملية تلدين اغشية TiO₂ تحت درجة حرارة 30°C شكل (3-3) يوضح فرن حرق استخدم في عملية تلدين اغشية 30

Thickness Measurement

8-3 قياس السمك

ان الاغشية المحضرة بتقنية الليزر النبضي كانت رقيقة جدا لهذا السبب استخدمنا الطريقة البصرية (He – Ne) لقياس سمك الغشاء لأنها اكثر دقة من الطرائق الاخرى ،اذ تم استعمال ليزر الهليوم – نيون (He – Ne) بطول موجي m 632 nm 632 حيث يكون سقوط شعاع الليزر بزاوية 45° على الغشاء والشعاع المنعكس يمرر من خلال عدسة لامة ليسقط على شاشة لرؤية الاهداب المضيئة والمظلمة كما مبين في الشكل (4-3) ومن قياس عرض الهدب المضيء X وعرض الهدب المظلم Y وبتطبيق العلاقة الآتية يحسب سمك الغشاء

$$t = \frac{Y}{X} \times \frac{\lambda}{2}$$
 (1-3)
حيث إن λ : الطول الموجي لليزر المستخدم
t : سمك الغشاء المحضر



شكل (3-4) يبين طريقة قياس سمك الأغشية الرقيقة المحضرة .

Structural Measurements

9-3 القياسات التركيبية

2-9-3 طبوغرافية السطح

بعد اتمام عملية الترسيب يتم اختيار عدد من الاغشية تمتاز بتجانسها وخلوها من الفجوات والعيوب الظاهرية لأجراء القياسات تضمنت القياسات التركيبية معرفة التركيب البلوري وطبوغرافية السطح للأغشية المحضرة باتباع تقنية حيود الاشعة السينية (XRD) والمجهر الالكتروني الماسح (SEM) ومجهر القوة الذرية (AFM).

X-ray Diffraction MeasurementInformation Seriesلأجل التعرف على الطبيعة السينية وطبيعة التركيب للأغشية الرقيقة وتأثير التلدين الحراري في الأغشيةتم استعمال جهاز حيود الاشعة السينية CuK نوع (SHIMADZU) الذي يعمل مع اشعة سينية بطولموجي ($^{\circ}A$ A) من مصدر ($_{\alpha}$) ولقد اجرى القياس بسر عة مسح (1.54 A) ولمدى زاوي(1.54 A) .(20 - 10 - 80) .

Surface Topography

لغرض فحص سطوح الاغشية الرقيقة تم التصوير باستخدام مجهر القوى الذرية (AFM) للحصول على تصوير ثلاثي الابعاد (dimension) و بقدرة تكبير مليون مرة حيث تم التعرف على تجانسية الغشاء

وتركيبه النانوي وايضا استعمل المجهر الالكتروني الماسح (SEM) بقدرات تكبير مختلفة. تم تصوير الاغشية بعد التلدين بدر جة حر ارة $^{\circ}C$ 250.

Optical Measurements

10-3 القياسات البصرية

تعد دراسة الخصائص البصرية بدء" من الثوابت البصرية وحساب فجوة الطاقة من الدراسات المهمة لعلاقتها بسلوكية المواد شبه الموصلة ولتحديد مدى ملائمتها للتطبيقات المختلفة تضمنت القياسات البصرية اجراء قياس الامتصاصية و النفاذية الطيفية والتي تستعمل لاحقا" في حساب معامل الامتصاص والذي بدوره يمكننا من حساب قيمة فجوة الطاقة تم استعمال مطياف من نوع -UV-VIS-NIR Double Beam Spectrometer ذي حزمتين للضوء يوضع في طريق احدهما اللوح الزجاجي المرسب عليه الغشاء والمراد اجراء القياسات له. بينما يوضع في طريق الحزمة الثانية المرجع وهو لوح زجاجي غير مرسب عليه. وقد اجريت القياسات لغشاء TiO2 ضمن مدى من الأطوال الموجية. .(350-900)nm

Calculation of Absorption Coefficient 1-10-3 حساب معامل الامتصاص يعد معامل الامتصاص واحد من المعلمات الفيزيائية المهمة التي يمكن من خلالها التعرف على حافة الامتصاص الأساسية وفجوة الطاقة ،يحسب معامل الامتصاص من العلاقة (2-14) .

Energy Gap Calculation

لقد تم حساب قيمة فجوة الطاقة المباشرة المسموحة لأغشية اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) باستخدام العلاقة (22-2) تم رسم منحنى بياني ما بين αv h) وطاقة الفوتون hυ يمكن ايجاد قيمة فجوة الطاقة بمد الجزء المستقيم من منحنى العلاقة ليقطع المحور السيني عند قيم طاقة الفوتون ، اذ تمثل نقطة التقاطع قيمة فجوة الطاقة المباشرة المسموحة

Optical Constants

Refractive Index

توصف الخصائص البصرية للمواد عادة بالثوابت البصرية التي تضم معامل الانكسار ومعامل الخمود وثابت العزل الكهربائي التي يمكن من خلالها التعرف على نوع التطبيقات البصرية الملائمة لهذه المو اد.

32

(n_o) معامل الانكسار (n_o) معامل الانكسار

11-3 الثوابت البصرية

2-10-3 حساب فجوة الطاقة

يعرف معامل الانكسار بانه النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ الي سرعته في الوسط وقد تم حسابه من العلاقة (2-23) بعد اعتمادها بدلالة الانعكاسية ومعامل الخمود.

Extinction Coefficient

(k_o) الخمود (k_o) الخمود

يعرف معامل الخمود على انه مقدار الفقدان في الطاقة الذي تعانيه الموجة الكهرومغناطيسية عند مرورها خلال المادة ويمكن حساب معامل الخمود بدلالة الطول الموجي ومعامل الامتصاص حسب العلاقة (27-2) .

Dielectric Constant

3-11-3 ثابت العزل الكهربائي (٤)

تم حساب ثابت العزل الكهربائي بجزئية الحقيقي والخيالي من العلاقتين الرياضيتين (2-31)(2-32).



1-4 مقدمة

Introduction

نستعرض في هذا الفصل النتائج التي حصلنا عليها والتي بدلالتها يمكن استقراء عمليات التبخير بالليزر، إذ تتباين خصائص الأغشية عند تباين ظروف التبخير ويتضمن هذا الفصل نتائج القياسات التركيبية والبصرية .

Structural Properties Results

X-Ray Diffraction (XRD)

أظهرت نتائج حيود الأشعة السينية أن غشاء ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) المحضر بالترسيب بالليزر النبضي ذات تركيب متعدد التبلور (Polycrystalline) وظهور طورين احدهما ذي طور Brookite وفي اتجاه (120) وعرض منتصف قمة FWHM مم 1.4° والمسافة البينية المه هي Brookite وفي اتجاه (120) وعرض منتصف قمة FWHM والمسافة البينية المه هي (3.527)nm وكان (3.527) وكانت ضعف الزاوية هي °Rutile وي الماطور الثاني فهو طور (2.2%) وكان الاتجاه السائد له في اتجاه (111) و FWHM هي °0.593 و المام الطور الثاني فهو طور (3.249) و كانت الاتجاه السائد له في اتجاه (111) و الملكل (1-4) والجدول (1-4) بالاعتماد على ظروف تحضير الاغشية الرقيقة.

Effect of Base Temperature

2-2-4 تأثير درجة حرارة الأساس

تؤدي درجة حرارة الأساس دوراً مهما في تحديد تركيب أغشية (TiO₂) المرسبة على قواعد زجاجية. يوضح الشكل (4-1) نتائج حيود الأشعة السينية للغشاء المرسب بدرجة حررارة أساس ^O 250 وكثافة طاقة ^C 0.08 J/cm² من الشكل (4-1) التركيب المتعدد التبلور (Polycrystalline) لغشاء (CiO₂) المرسب عند درجة حرارة أساس ^O 250 . وعند درجة الحرارة المذكورة تظهر لدينا مستويات بلورية في طور Brookite في الاتجاه (2019) عند ^O موضح بالشكل (4-1) ، وهذا يدل على تحول تركيب غشاء (CiO₂) من الطور Brookite النور المستوي البلوري في طور Rutile في الاتجاه (I10) عند موضح بالشكل (4-1) ، وهذا يدل على تحول تركيب غشاء (CiO₂) من الطور Brookite إلى الطور رويادة انتشار الأوكسجين داخل الغشاء تؤدي الى زيادة قوة الآصرة OI من الطور TiO₂)، حيث وجدوا أن زيادة انتشار الأوكسجين داخل الغشاء تؤدي الى زيادة قوة الآصرة OI OI من

وقد جرى حساب معدل الحجم البلوري (Crystallite size) بتطبيق المعادلة (2-2)، بالإضافة إلى حساب كثافة الانخلاع حسب المعادلة (2-2) والمطاوعة الميكروية من العلاقة (2-5) كما هو موضح بالجدول (1-4).

2-4 نتائج القياسات التركيبية

1-2-4 حيود الأشعة السينية



شكل (1-4) حيود الأشعة السينية لأغشية TiO₂ النقية المحضرة باستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)

20 (deg.)	d _{hkl} (nm)	(hkl)	FWHM (deg.)	Crystallite Size (nm)	Micro strain (lin ⁻² m ⁻⁴)	dislocation density *10 ⁻² (lin m ⁻²)
25.231	3.527	B(120)	1.400	5.813	0.342	2.960
27.520	3.249	R(111)	0.593	13.860	0.144	0. 520
36.087	2.487	R(012)	0.500	16.720	0.119	0. 358
43.821	2.064	R(221)	0.460	18.610	0.107	0. 289
54.306	1.688	R(320)	0.440	20.285	0.098	0. 243

جدول (1-4) يبين نتائج حيود الأشعة السينية لأغشية TiO₂ المحضرة بتقنية الليزر النبضي (PLD)

من خلال الجدول في أعلاه يمكن ملاحظة التغير الواضح في الحجم البلوري نتيجة لتحول الطور من Brookite في المستوي (120) الى طور Rutile عند درجة حرارة الأساس C° 250، حيث إن زيادة الحجم البلوري تشير إلى التغير في طور التركيب البلوري للغشاء وحدوث تحول في تركيبه والدليل على ذلك هو ظهور مستوي بلوري جديد (R(111) . كذلك نلاحظ انخفاض القمة للمستوي مع نقصان كبير في عرض منتصف القمة (FWHM) مما يعنى زيادة في الحجم البلوري للغشاء.

4-2-4 قياسات المجهر الالكتروني الماسح

Scanning Electronic Microscope Measurement (SEM) يوضح الشكل (2-4) صورةً غشاء (TiO₂) باستخدام المجهر الألكتروني الماسح المرسب تحت درجة حرارة C° (250) وضغط أوك سجين mbar وك ثافة طاقة ليزر 250° 0.08 J/cm

يتضح من خلال الشكل أن سطح غشاء (TiO₂) يكون خالي من الفجوات. عند درجة حرارة 20° C فان حجم حبيبات الغشاء تزداد مع زيادة حجم كل حبيبة. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحجم البلوري الابتدائي للطورين Brookite و Rutile يزداد بارتفاع درجة حرارة الأساس بالإضافة إلى إن زيادة عدد نبضات الليزر يزيد من تجمع الجزيئات مع بعضها البعض، وبالتالي يكون حجم الجزيئات المتجمعة اكبر . ويبلغ متوسط الحجم الحبيبي الذي جرى حسابه حسب قياسات (SEM) هي nm (33)



شكل (2-4) صورة SEM لغشاء TiO₂ المحضر بتقنية الليزر النبضى (PLD)

Atomic Force Microscope Measurements (AFM) قياسات مجهر القوة الذرية (4-2-4



شكل (AFM) صور AFM لغشاء TiO₂ المحضر بتقنية الليزر النبضي (PLD)

جدول (3-4) يبتن الخصائص تركيبية والطبوغرافية لأغشية TiO₂ المحضرة بتقنية الليزر النبضي وكثافة طاقة ليزر 2.00 J/cm

RMS(nm)	خشونة السطح RA(nm)	الحجم الحبيبي حسب قياسات AFM (nm)	الحجم الحبيبي حسب قياسات SEM (nm)	الحجم البلوري حسب قياسات XRD (nm)	العينة TiO ₂
14.3	11.8	30.55	33	15.1	

Optical Properties

3-4 الخصائص البصرية

تعد الخصائص البصرية من الخصائص المهمة والتي يعول عليها كثيراً في تحديد تطبيقات الأغشية الرقيقة والتي يمكن اعتمادها أيضا لحساب العديد من الثوابت البصرية مثل معامل الامتصاص ومعامل الانكسار ومعامل الخمود وثابت العزل الكهربائي بجزئية الحقيقي والخيالي ، وفي قياساتنا درست الخصائص البصرية لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) المحضرة بظروف مختلفة وذلك بالاعتماد على طيفي الامتصاصية و النفاذية.

1-3-4 طيف الامتصاصية

Absorption Spectrum

يبين الشكل (4-4) طيف الامتصاصية كدالة لتغير الطول الموجي للمدى من nm (350-050) لأغشية (TiO₂) المرسبة على قواعد زجاجية بظروف تحضير مختلفة . حيث نلاحظ إن قيمة الاعتصاصية تقل مع ازدياد الطول الموجي ، ونجد إن قيمة الامتصاصية تتناقص بشكل قليل في منطقة المتصاصية تقل مع ازدياد الطول الموجي ، ونجد إن قيمة الامتصاصية تتناقص بشكل قليل في منطقة الطاقات الواطئة (الأطوال الموجية العالية) بينما تزداد قيمة الامتصاصية بصورة كبيرة في منطقة الطاقات الواطئة (الأطوال الموجية العالية) بينما تزداد قيمة الامتصاصية بصورة كبيرة في منطقة الطاقات الواطئة (الأطوال الموجية العالية) بينما تزداد عدد نبضات الليزر لها تأثير ملحوظ في امتصاصية الطاقات الطاقات العالية (الأطوال الموجية العالية) ، زيادة عدد نبضات الليزر لها تأثير ملحوظ في امتصاصية الأغشية المحضرة إذ يبين الشكل (4-4) انخفاض في الامتصاصية بزيادة عدد النبضات بسبب ازدياد النفاذية المصرية وهذا بسبب زيادة الحجم الحبيبي وخشونة السطح ولهذا فإن الغشاء المحضر بدرجة النفاذية الساح ولهذا فإن الغشاء المحضر بدرجة النفاذية الماس Ω° (250) يظهر أعلى قيمة للامتصاصية .



شكل (4-4) طيف الامتصاصية لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين mbar ⁵⁻ 10 ودرجة حرارة C° 250 وكثافة طاقة الليز 0.08J/cm² وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)

10⁻⁵

كذلك نلاحظ من الشكل السابق أن حافة الامتصاص تظهر إزاحة نحو المنطقة تحت الحمراء (Red region shift) مع ظروف التحضير المختلفة وهنالك سببان لذلك وهما زيادة الحجم البلوري بالإضافة إلى تحول طور الغشاء من Brookite إلى Rutile وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض في فجوة الطاقة.

2-3-4 طيف النفاذية

Transmittance Spectrum

يـوضح الشـكل (4-5) طـيف النـفاذية كـدالة لتغير الطول الموجي للمدى بين (500-350) nm لأغشية (TiO₂) المرسبة على قواعد زجاجية بدرجة حرارة أساس C⁰ 250 بثبوت ظروف التبخير الأخرى المتمثلة بضغط أوكسجين mbar⁽⁵⁻¹⁰⁾ وكثافة طاقة الليزر 200⁻²⁰⁰ . نــلحظ أن نفــاذية غشاء (TiO₂) تزداد كلما أزداد الطول الموجي حيث إن معدل نفاذية الغشاء تجاوزت (80%) في المنطقة المرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء للأغشية المرسبة بدرجة حرارة أساس O.8 الأس

يتفق مع النتائج التي حصل عليها Caricatoa وجماعته [59] .



شكل (5-4) طيف النفاذية لأغشية TiO_2 المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين TiO_2 مكل (5-4) طيف النفاذية لأغشية 250 وكثافة طاقة الليزر 2 mbar ودرجة حرارة C و250 °C وكثافة طاقة الليزر PLD)

4-3-3 طيف الانعكاسية

Reflectance Spectrum

تعرف الانعكاسية بأنها النسبة بين مقدار الأشعة المنعكسة في أثناء سقوط الإشعاع على سطح الغشاء الرقيق إلى مقدار الإشعاع الساقط تم حساب الانعكاسية من طيف الامتصاصية والنفاذية، وبموجب قانون حفظ الطاقة حسب العلاقة (2-26).

الشكل (4-6) يبين تغير الانعكاسية لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) كدالة للطول الموجي ضمن المدى الطيفي من nm (350 950) ، اذ نلاحظ أن الانعكاسية تزداد بزيادة عدد نبضات الليزر وتنخفض تدريجيا بزيادة الطول الموجي وتكون اعلى قيمة للانعكاسية عند الطول الموجي nm (350) ، وتفسير ذلك يعود لكون الامتصاصية قليلة جداً عند الاطوال الموجية العالية ولكن عند الاطوال الموجية الواطئة سوف تزداد الامتصاصية نتيجة الانتقالات الالكترونية بين حزمة التكافؤ وحزمة التوصيل مما يسبب زيادة في قيم الانعكاسية . بالاضافة الى ذلك ان التلدين يؤدي الى تتناقص قيم الانعكاسية ، ويمكن تفسير ذلك بان سطوح الأغشية تأثرت بشكل كبير عند أجراء التلدين.



شكل (6-4) طيف الانعكاسية لأغشية TiO_2 المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين - mbar ودرجة حرارة C° 250 وكثافة طاقة الليزر 2 0.08J/cm وباستخدام تقنية الليزر النبضي 10⁵ mbar ودرجة حرارة C)

Absorption Coefficient Measurement

4-3-4 حساب معامل الامتصاص

يعرف معامل الامتصاص (α) بأنه قياس لنسبة الخسارة في الضوء من الحزمة الساقطة مباشرة خلال سمك معين . يوضح الشكل (4-7) معامل الامتصاص لأغشية (TiO₂) كدالة للطول الموجي للمدى بين nm (350-950) والمرسبة على قواعد زجاجية بظروف تحضير مختلفة. وكما هو واضح من الشكل فأن قيمة معامل الامتصاص أكبر من (^{1-cm}) للطول الموجي nm (350) ، وإن هذه القيمة تنخفض مع زيادة الاطوال الموجية وهذا يساعد على توقع حدوث انتقالات الكترونية غير مباشرة ضمن مدى الاطوال الموجية من (950 - 750) .



شكل (7-4) معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لأغشية TiO_2 المحضرة باختلاف عدد نبضات $0.08J/cm^2$ ويضافة طاقة الليزر 2 0.08J/cm الليزر وبضغط اوكسجين 2 0.08J/cm ودرجة حرارة 2 و250 وكثافة طاقة الليزر 2

Optical Energy Gap Measurement

4-3-3 حساب فجوة الطاقة البصرية

تعتبر فجوة الطاقة البصرية من أهم الثوابت في فيزياء أشباه الموصلات، إذ يعتمد على قيمة هذا الثابت استخدام شبه الموصل في التطبيقات البصرية والالكترونية . وتعتمد قيمة فجوة الطاقة على التركيب البلوري للمادة ويمكن تحديد قيمة فجوة الطاقة (E_g) من خلال معرفة قيمة معامل الامتصاص وطاقة الفوتون الساقط . من خلال رسم المنحني البياني بين² (αhv) و ^{1/2} (αhv) على المحور الصادي مع (hv) على المحور السيني ومن تقاطع مماس المنحني مع محور (wh)، فإن نقطة التقاطع هذه تمثل قيمة فجوة الطاقة ، والشكلين (4-8) ، (4-9) تبين تحديد قيم فجوة الطاقة المباشرة وغير المباشرة على التوالي لأغشية (4-9) المحضرة بظروف تحضير مختلفة. والجدول (4-4) يبين قيم فجوة الطاقة ، الغشاء اعتماداً على ظروف تحضيره .



شكل (4-8) العلاقة بين $(\alpha hv)^2$ وطاقة الفوتون (hv) لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات (αhv) الليزر وبضغط اوكسجين mbar ودرجة حرارة C° 200 وكثافة طاقة الليزر² 0.08J/cm وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)



شكل (4-9) العلاقة بين $(\alpha hv)^{1/2}$ وطاقة الفوتون (hv) لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات mbar ألليزر وبضغط اوكسجين mbar أ⁵ mbar ودرجة حرارة C° 250 وكثافة طاقة الليزر $(0.08 J/cm^2)$ ولليزر وبضغط اوكسجين mbar وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)

نلاحظ من الشكل (4-8) والجدول (4-4) أن زيادة عدد نبضات الليزر تقلل من قيم فجوة الطاقة المباشرة ، وإن سبب هذه الزيادة في فجوة الطاقة يعزى إلى تحسن الخصائص التركيبية لغشاء (TiO₂) حيث إن زيادة عدد نبضات الليزر تؤدي إلى زيادة المستويات الموضعية وبالتالي ينخفض التركيب البلوري للغشاء وتنخفض فجوة الطاقة كما موضح في الجدول (4-4) ، بينما لا تتأثر فجوة الطاقة غير المباشرة بزيادة عدد نبضات الليزر وهذا ما أكدته فحوصات الأشعة السينية.

العينات	فجوة الطاقة البصرية	فجوة الطاقة البصرية
	المباشرة (eV)	غير المباشرة (eV)
$TiO_2 - 25P$	3.5	3.45
$TiO_2 - 50P$	3.45	3.45
TiO ₂ -75P	3.4	3.45

جدول (4-4) قياسات فجوة الطاقة البصرية المباشرة وغير المباشرة لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم TiO₂ النقية

Refractive Index

4- 3-3 حساب معامل الانكسار

ترتبط انعكاسية الغشاء مع معامل الانكسار حسب المعادلة (2 - 24) ومنها يمكن حساب معامل الانكسار حسب المعادلة (2- 25).

الشكل (4-10) يبين تغير معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) ، ومنه نلاحظ زيادة معامل الانكسار بزيادة عدد نبضات الليزر وينخفض مع زيادة الطول الموجي حيث ان اقصى معامل انكسار عند الطول الموجي nm (350). كما نلاحظ أن تغير منحنيات معامل الانكسار من حيث الشكل العام شبيهة نوعاً ما بتغير منحنيات الانعكاسية مع الطول الموجي.



شكل (10-4) معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لأغشية ${
m TiO_2}$ المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين mbar $^{-5}$ mbar ودرجة حرارة 20° 250 وكثافة طاقة الليزر النبضات الليزر وبصغط او 0.08J/cm²

4 - 3 - 7 حساب معامل الخمود

Extinction Coefficient

يمثل معامل الخمود كمية الطاقة الممتصة من الغشاء الرقيق، كما يمثل الجزء الخيالي من معامل الانكسار المعقد (ko)، ويرتبط معامل المعروف بـ (معامل الخمود مله) ، ويرتبط معامل الخمود بمعامل الخمود للأغشية الخمود بمعامل الامتصاص حسب العلاقة (2 - 27) والتي من خلالها يُحسب معامل الخمود للأغشية المحضرة.

الشكل (4-11) يبين علاقة تغير معامل الخمود كدالة للطول الموجي لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) المحضرة تحت ظروف معينة. إذ نلاحظ ان هناك زيادة لقيم معامل الخمود بزيادة عدد نبضات الليزر بمقدار وهناك انخفاض في قيم معامل الخمود بزيادة الطول الموجي ونلاحظ اقصى قيمة لمعامل النرر بمقدار وهناك انخفاض في قيم معامل الخمود بزيادة تدل على حدوث انتقالات الكترونية بين حزمة الخمود عند الطول الموجي ومن ثمَّ زيادة واضحة في معامل التكافؤ وحزمة التوصيل والتي أديادة معامل الأمود في معامل الخمود بزيادة عدد نبضات الخمود عند الطول الموجي ونلاحظ اقصى قيمة لمعامل الخمود عند الطول الموجي ونلاحظ اقصى قيمة لمعامل الخمود عند الطول الموجي ونلاحظ المعامل الخمود عند الطول الموجي ونلاحظ المعامل الخمود عند الطول الموجي معامل الخمود معامل الخمود معامل الخمود معامل الخمود معامل الموجي التقالات الكترونية بين حزمة الخمود عند الطول الموجي معامل الموجي معامل الخمود معامل الموجي والتونية بين حزمة الخمود عند الطول الموجي والزائم والتي أدت إلى زيادة معامل الامتصاص ومن ثمَّ زيادة واضحة في معامل الخمود حسب المعادلة (2 - 27).



شكل (11-4) معامل الخمود كدالة للطول الموجي لأغشية TiO_2 المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين mbar ودرجة حرارة C $^{\circ}C$ وكثافة طاقة الليزر 2 mbar الليزر وبضغط اوكسجين (PLD) ودرجة الليزر النبضي (PLD)

4-3-8 حساب ثابت العزل الكهربائي

Dielectric Constant

إن التفاعل بين الضوء وشحنات الوسط يكون بسبب عملية امتصاص الطاقة في المادة ، ومن ثم حصول عملية استقطاب يوصف عادة بثابت العزل الكهربائي المعقد (ع).

يبين الشكل (4-12) تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي كدالة للطول الموجي للفوتون الساقط لأغشية (TiO₂) المحضرة بظروف معينة، إذ نلاحظ أن المنحنيات تشبه إلى حد ما سلوك معامل الانكسار وذلك وفقا للمعادلة (2-23) . يدعى ثابت العزل الخيالي أحيانا بمعامل العزل الكهربائي (Dielectric factor) وهو يشير إلى مقدار الفقد في طاقة الموجة الكهرومغناطيسية عند محاولة مركبتها الكهربائية توجيه ثنائيات القطب (Dipoles) في المادة باتجاه المجال المسلط للموجة ، وعند محاولة استجابة ثنائيات القطب الموجة الكهربائية هذه الاستجابة ويعمل على محاولة استجابة ثنائيات القطب الموجة الكهربائية للمجال مما يسبب خسائر في القدرة.

يبين الشكل (4 -13) تغير الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي كدالة للطول الموجي للفوتون الساقط لأغشية (TiO₂) المحضرة بظروف معينة حيث نلاحظ إن سلوك المنحنيات يشبه إلى حد ما سلوك معامل الخمود .



شكل (12-4) ثابت العزل الحقيقي كدالة للطول الموجي لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر 9⁻¹² (0.08J/cm² ودرجة حرارة C⁶ وكثافة طاقة الليزر² 0.08J/cm وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)



شكل (13-4) ثابت العزل الخيالي كدالة للطول الموجي لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين mbar ودرجة حرارة C° 200 وكثافة طاقة الليزر² 0.08J/cm وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)

Optical Conductivity

4-3-9 حساب التوصيلية البصرية

تم حساب التوصيلية البصرية حسب المعادلة (2-34). الشكل (4 - 14) يبين تغير التوصيلية البصرية كدالة للطول الموجي لطاقة الفوتون الساقط لغشاء ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) ، ونلاحظ ان قيمها تزداد بزيادة عدد نبضات الليزر وتنخفض بزيادة الطول الموجي وتكون اقصى توصيلية عند الطول الموجي nm (350) وعند عدد نبضات (75) وكانت $^{1-1} S^{-1} \times (2.69)$.



شكل (14-4) التوصيلية البصرية كدالة للطول الموجي لأغشية TiO₂ المحضرة باختلاف عدد نبضات الليزر وبضغط اوكسجين mbar ⁵⁻ 10 ودرجة حرارة C^o 250 وكثافة طاقة الليزر² 0.08J/cm وباستخدام تقنية الليزر النبضي (PLD)

Conclusions

4-4 الاستنتاجات

- 1- نفاذية أغشية TiO₂ تظهر قيماً اكبر من (80%) للضوء المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء عند ظروف تحضير معينة ، ولهذا السبب تستخدم أغشية TiO₂ كنوافذ للخلايا الشمسية.
- 2- تمتلك الأغشية فجوة طاقة مباشرة مقدارها eV (3.5) وتنخفض بزيادة عدد نبضات الليزر وفجوة طاقة غير مباشرة مقدارها eV (3.45) ولا تتأثر بزيادة عدد نبضات الليزر عند درجة حرارة أساس C° (250) وضغط أوكسجين mbar $^{-5}$ mbar ليزر J/cm^2 وكثافة طاقة ليزر J/cm² 0.08

5-4 المشاريع المستقبلية

Future Projects

- دراسة الخصائص الكهربائية لأغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂).
- NO ،CO تحضير أغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) كمتحسسات للغازات السامة مثل O ،CO و NO_2 .
 - 3- تحضير أغشية ثاني اوكسيد التيتانيوم (TiO₂) كخلايا شمسية .



- T.J.Coutts, Simmone J.G "Hand Book of Thin Film Device", Edited by, Academic Press, New York (1971).
- [2] K.D.Lever, "Thin Films " London (1978).
- [3] Frncisco, E.Bermejo, M.Garcia Baonza, V.Gerward and L.Recio,
 "Spinodal Equation of State for Rutile TiO₂", Physical Review B.1-064110
 (6) 67, (2003).
- [4] M. Walczak, E.L. Papadopoulou, M. Sanz, A. Manousaki, J.F. Marco, M. Castillejo, "Structural and morphological characterization of TiO₂ nanostructured films grown by nanosecond pulsed laser deposition " Applied Surface Science., Vol. 31, p.250, (2008).
- [5] Anna Paola Caricato, Armando Luches and Roberto Rella, "Nanopartical Thin Films for Gas Sensor Preperted by Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation", Sensors, p.2682, (2009).
- [6] هبة سلام طارق ، " تحضير أغشية اكاسيد النحاس CuO و Cu₂O بوساطة الليزر ودراسة خصائصها التركيبية والبصرية" ، قسم العلوم التطبيقية في الجامعة التكنلوجية ، أطروحة ماجستير ، (2009) .
- [7] H.Lin , Demin Wang and C.P.Huang , "Photocatalytic Activity of Pulsed Laser Deposited TiO_2 Thin Films" , Department of Civil and Environmental Engineering , University of Delaware , Newark , USA , (2007).
- [8] M.Stamate and I.Vascan, "Variable Optical Band Gap for TiO₂ Thin Films Deposited in a D.C.Magnetron Sputtering System", Fizica Starii Condensate, pp.(173-175), (1999).
- [9] Kishor Karki , K.I.Gnanasekar and B.Rambabu "Nanostructure Semiconductor Oxide Powders and Thin Films for Gas Sensors" Appl. Sur. Sci. ,Vol. 399, p. (193-195), (2006).
- [10] C.R Phipps, Jr., T. P. Turner, R.F. Harrison, G.W. York, W.Z. Osborne, G.K. Anderson, X.F. Corlis, L.C. Haynes, H. S. Steele, and Spicochi and

T.R. King , "Impulse Coupling to Targets in Vacuum by KrF, HF and CO₂ Single –Pulse Laser", J. Appl. Phys. ,Vol. 643 , p. 1083 (1988) .

- [11] R.S. Rusu and G .I. Rusu , "On the Electrical Properties of TiO₂ Thin Film", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 7, p234, (2005).
- [12] W. D. Broewn and W.W.Grannemann ,"C-V Characteristics of Metal -Titanium Dioxide-Silicon Capacitors", Solid-State Electronics, Vol. 21, pp.(837-846), (1977).
- [13] M. Lottiaux , C.Boulesteix , G.Nihoul , F. Varnier , F. Flory , R. Galindo and E. Pelletier ," Morphlogy and Structure of TiO₂ Thin Layers v.s Thickness and Substrate Temperature", Thin Solid Films ,Vol. 170, pp.(107-126) , (1989) .
- [14] L. Escobar-Alarcon, E. Haro-Poniatowski, M. A. Camacho-Lopez, M. Fernandez-Guasti, J. Jimenez- Jarquim and A. Sanchez-Pineda, "Structural Characterization of TiO₂ Thin Films Obtained by Pulsed Laser Deposition", Applied Surface Science, Vol. 137, pp.(38-44), (1999).
- [15] Mona P. Moret, Richard Zallen, Dilip P. Vijay and Seshhu B. Desu, "Brookite-Rich Titania Films Made by Pulsed Laser Deposition", Thin Solid Films, Vol. 366, pp.(8-10), (2000).
- [16] D. Mardare and G. I. Rusu, "The Structure and Optical Dielectric Constants of TiO₂ Sputtered Thin Films", Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 3, No.1, pp.(95-100), (2001).
- [17] D. Dzibrou , A.M. Grishin and H. Kawasaki ," Pulsed laser deposited TiO₂
 Films: Tailoring optical properties ", Thin Solid Films ,Vol. 316, pp. (6697–6701) , (2002) .
- [18] A. K. Sharma, R. K. Thareja, Ulrike Willer and Wolfgang Schade, "Phase Transformation in Room Temperature Pulsed Laser Deposited TiO₂ Thin Films", Applied Surface Science, Vol. 206, pp.(137-148), (2003).

- [19] Sin-iti Kitazawa, Yeongsoo Choi and Shunya Yamamoto, "In Situ Optical Spectroscopy of PLD of Nano-Structured TiO₂", Vacuum ,Vol. 74, pp.(637-642), (2004).
- [20] Yoshiaki Suda, Hiroharu Kawasaki, Tsuyoshi Ueda and Tamiko Ohshima,
 " Preparation of High Quality Nitrogen Doped TiO₂ Thin Film as a Photocatalyst Using a Pulsed Laser Deposition Method", Thin Solid Films, Vol. 454, p.162, (2004).
- [21] Tamiko Ohshima , Shouta Nakashima , Tsuyoshi Ueda , Hiroharu Kawasaki , Yoshiaki Suda and Kenji Ebihara ," Laser Ablated Plasma Plume Characteristics for Photocatalyst TiO₂ Thin Films Preparation ", Thin Solid Films ,Vol. 319 , pp. (6880–6883) , (2005) .
- [22] Dongsum Yoo, Ilgon Kim, Sangsoo Kim, Chang Hie Hahn, Changyu Lee and Seongjin Cho, "Effect of Annealing Temperature and Method on Structural and Optical Properties of TiO₂ Films Prepared by RF Magnetron Sputtering at Room Temperature", Applied Surface Science, Vol. 253, pp.(3888-3892), (2007).
- [23] M. Hemissi and H.Amardjia-Adnani, "Optical and Structral Properties of Titanium Oxide Thin Films Prepared by Sol-Gel Merhod", Jornal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 2, No.4, pp.(299-305), (2007).
- [24] S. Sankar and K. G. Gopchandran, "Effect of Annealing on the Structural, Electrical and Optical Properties of Nanostructured TiO₂ Thin Films", Cryst. Res. Technol, Vol. 44, No.9, pp.(989-994), (2009).
- [25] Gaurav Shukia, Pratima K.Mishra and Alika Khare, "Effect of Annealing and O₂ Pressure on Structural and Optical Properties of Pulsed Laser Deposited TiO₂ Thin Film ", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 489, pp.(246-251), (2010).
- [26] C. Kittel, "Introduction to solid state physics", 6th. Edition, Wiley, (1986).

- [27] P. J. Brown and j. B. Forsyth, "The crystal structure of solid", Arnold,(1973).
 - [28] أس أم. زي، "نبائط أشباه الموصلات فيزياء وتقنية" ، دار الحكمة للطباعة والنشر (الموصل)، ترجمة د. فهر غالب حيالي ود. حسين على أحمد (1990).
- [29] B.L. Mattes, "Polycrystalline and Amorphous thin films and devices", Academic Press, (1980).
- [30] D. A. Neamen, "Semiconductor Physics and Devices", University of New Mexico, (1992).
- [31] S. Franssila, "Introduction to Microfabrication", West Sussex, England, John Wiley and Sons Ltd, (2004).
- [32] C. Kittel, "Introduction to solid state physics", John Wiley and sons, 5th Edition, (1986).
- [33] W. D. Callister, "Materials Science and Engineering", 4th Edition, (1997).
- [34] D.K. Dwivedi, Dayashankar, Maheshwar Dubey, "Effect Of Annealing On The Structural And Electrical Properties Of Cdte/Znte Heterojunction Thin Films", Rom. Journ. Phys., Vol. 55, Nos. 3–4, pp. (352–359), (2010).
- [35] L. Pawlowski "The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings", John Wiley and sons, 2nd. Edition, France, book, (2007).
- [36] Y.N.AL-Jammal ," Soild state physics", AL- Mousul University ,Arabic version , (1990).
- [37] M. G. Yousif, "Soild state physics" ,Vol.2, University of Baghdad book, (1989).
- [38] J. Pattar, S. N. Sawant, M. Nagaraja, N. Shashank, K. M. Balakrishna, G. Sanjeev and H. M. Mahesh, "Structural Optical and Electrical Properties of Vacuum Evaporated Indium Doped Zinc Telluride Thin Films", Int. J. Electrochem. Sci., Vol. 4,pp. (369-376), (2009).

- [39] M. Dhanam, R.R. prabhu and P.K. Manoj, "Investigations on chemical bath deposited Cadmium Selenide thin films", Materials Ch and Phy, Vol. 107, pp. (289-296), (2008).
- [40] S. Dimitriev, "Understanding Semiconductor Devices", Griffth University, New York, Oxford, (2000).
- [41] F. Scholz, "Compound Semiconductors", book, (2009).
- [42] M. G. Yousif, "Soild state physics" ,Vol.1, University of Baghdad book, (1989).
- [43] J. I. Pankove, "Optical Processes in Semiconductors", Prentice-Hall, New Jersey, (1971).
- [44] A. H. Clark, "Optical properties of polycrystalline and amorphous thin films and devices ", edited by Laurece. L. Kazemerki, Academic press, (1960).
- [45] S. Ben ,"Solid State Electronic Devices", Hall International, Inc, U. S. A., (1990).
- [46] M. S. Dresselhaus, "Optical Properties of Solids", Part II, (1998).
- [47] Y. Sirotin ,Y. M. Shaskolskaya ,"Fundamentals of crystal physics ", Mir Publishers , Moscow, (1982).
- [48] V. Kumar, G. S. Sandhu, T. P. Sharma, and M. Hussain, "Growth and Characterization of Cd_{1- x}Zn_xTe-Sintered Films", Research Letters in Materials Science, (2007).
- [49] Li Jin , Yang Linyu , Jian Jikang , Zou Hua , and Sun Yanfei , "Effects of Sn-doping on morphology and optical properties of CdTe polycrystalline films", Journal of Semiconductors, Vol. 30, No. (10-11) , pp.(1577-1580), (2008).
- [50] G. Gordillo, F. Rojas and C. Calderón, "Optical characterization of Cd(Sx,Te1-x) thin films deposited by evaporation", Superficies y Vacío, Vol. 16, No. 3, pp.(30-33), (2003).

- [51] G. G. Rusu, M. Rusu, "Optical Behavior of Multilayered Cdte/Cu Thin Films Deposited By Stacked Layer Method", J. of Opt. and Advanced Materials, Vol. 7, No. 2, pp. (885 – 889), (2005).
- [52] M. Marafi, F. El Akkad, B. Pradeep, "Properties of R.F. Sputtered Cadmium Telluride Thin Films", Journal of Materials Science, Vol.14, pp. (21 – 26), (2003).
- [53] S. Weng , M. Cocivera , "Preparation and Properties of Cadmium Telluride Prepared by a Three-Step Process" , Chem. Mater., Vol. 5, pp.(1577-1580), (1993).
- [54] J. D. Kraus, "Electromagnetic ", 3rd Ed., Mc Graw-Hill, (1984).

[55] د. رائد عبد الوهاب ، أ.د وليد خلف حمودي ، " تحسين الخصائص الكهربائية لكاشف سيليكوني ثنائي الوصلة"، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 23 ، العدد 5 ، رقم الصفحة (246 – 250)، (2004).

- [56] د. رائد عبد الوهاب ، د وليد خلف حمودي ، " تصنيع و تحسين خصائص كاشف سيليكوني نوع ثنائي الوصلة "، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد 20، العدد 4، رقم الصفحة (169–179)، (2001).
- [57] Inoue, Yuasa and Okoshi, "Pd Doped TiO₂ Thin Films Prepared by PLD for Gas Sensors Applications ", Applied surface science, Vol. 319, p. 686, (2006).
- [58] G. Korotcenkov, Sang Do Han and D. Fisher," (Cu, Fe, Co, or Ni)-Doped TiO₂ Films Deposited by Spray Pyrolysis: Doping Influence on Thermal Stability of The Film Structure ", Materials Chemistry and Physics ,Vol. 113, pp.(756–760), (1997).
- [59] A. P. Caricatoa , M. Catalanob , G. Ciccarellac , M. Martinoa , R. Rellab ,
 F. Romanoa , J. Spadavecchiab , A. Taurinob , T. Tunnoa and D. Valerinia,
 " Matrix Assisted Pulsed Laser Evaporation for TiO₂ Nanoparticle Thin Film Deposition", Journal of Nanomaterials and Biostructures ,Vol.1,No. 2 , pp. (43 47) , (2005) .

Summary

TiO₂ films have been prepared by pulsed laser deposition using a Nd:YAG laser beam (λ =532) nm , preparation on glass substrate with determine conditions including substrate temperature (250) °C , oxygen pressure 10⁻⁵ mbar, laser energy density 0.08 J/cm² , and number of laser pulses (25 , 50, and 75) then studying structural and optical properties of TiO² thin films preparing in this conditions.

Since TiO_2 films are highly dependent on the base temperature, we observed at 250 °C that the film structure turn from the Brookite phase to the stable Rutile phase. The surface topography was studied using a scanning electron microscopy (SEM) and an atomic force microscope (AFM).

The surface morphology of the deposits materials have been studied by using scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM) the average grain size according to the measurements (SEM) is (33) nm. The AFM measurements have a grain size of 30.55 nm and the surface roughness is 11.8 nm and the average square root of the roughness (RMS) is 14.3 nm.

Optical properties were investigated by obtaining the transmittance spectrums in the UV-Visible regions as a function of wavelength. Transmittance results is upper than ~80% which makes these films suitable for solar cells applications. Direct energy gap value 3.5 eV and indirect 3.45 eV at substrate temperature 250 °C respectively at oxygen pressure 10^{-5} mbar , laser energy density 0.08 J/cm² , and number of laser pulses (25 , 50, and 75). we found that the direct optical energy gap value decreased with increasing number of laser pulses.

Also the optical constants such as refractive index, extinction coefficient and dielectric constant by two parts real and imaginary dielectric have been calculated for preparing film.

Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Al- Qadisiyah College of Science Department of Environment



Study of Structural And Optical Properties of Dioxide Titanium

Research Submitted to the Department of Environment , College of Science , University of Al - Qadisiyah as Part of the Requirements Obtain a Degree Bachelor in Environmental Sciences

By

Saad Qais Hussein and Ali Abdel-Hussein Taha

Supervision

Dr. Saleem Hamza Al- Taweel

2018 A.D

1439A.H